

ОБЗОРЫ

УДК 541.16

СОЕДИНЕНИЯ ТОРИЯ С НЕМЕТАЛЛАМИ: ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ,
ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

© 2008 И.Р. Шеин, А.Л. Ивановский*

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург

Статья поступила 26 июня 2007 г.

Представлен обзор текущего состояния исследований в рамках современных неэмпирических методов вычислительной зонной теории электронной структуры, природы химической связи и ряда физико-химических свойств бинарных Th—X (X = H, B, C, N, O, P, S, As, Se, Sb) и тройных (карбонитриды, тораты и силикаты) соединений тория. Обсуждаются возможности неэмпирических зонных методов для описания структурных состояний, фазовой стабильности, упругих характеристик, рентгеновских эмиссионных, абсорбционных и фотоэлектронных спектров торийсодержащих систем.

Ключевые слова: двойные, тройные торийсодержащие фазы, электронное строение, химическая связь, компьютерное материаловедение.

ВВЕДЕНИЕ

Торий и его соединения [1–8] привлекают внимание прежде всего как перспективные материалы экспериментальных ядерных реакторов с замкнутым топливным циклом, которые должны обеспечивать высокий уровень безопасности. Для исследований и прогноза свойств торийсодержащих материалов, а также моделирования способов направленного регулирования их функциональных характеристик в последние годы все более активно привлекаются методы компьютерного материаловедения, использующие неэмпирические подходы вычислительной квантовой теории конденсированного состояния вещества.

Целью настоящего обзора является анализ текущего состояния исследований в области компьютерного материаловедения и теоретического прогноза свойств торийсодержащих систем, основанных на результатах их неэмпирических зонных расчетов.

В работе суммированы результаты по моделированию бинарных соединений тория с водородом, бором, углеродом, азотом, кислородом, а также некоторыми 3p-5p-элементами. Многие из этих соединений являются основой так называемых реакторных материалов. К этой же группе материалов относят и большинство обсуждаемых в работе тройных торийсодержащих фаз со структурой первовскита, а также карбонитриды тория. Кроме того, рассмотрены тройные фазы — силикаты тория, которые представляют особый интерес как минералы, являющиеся основными природными источниками тория.

Подчеркнем, что в данном обзоре мы сосредоточились на систематическом изложении имеющихся результатов по твердофазным соединениям тория с sp-неметаллами. Анализ многочисленных данных по торийсодержащим комплексам и молекулам, как и имеющихся сведений об электронной структуре некоторых сплавов тория с p, d, f-металлами (например, Th—Al [9], Th—Ce [10, 11] U—Th—Pd [12]) выходит за рамки настоящей работы. Описание особенностей зонной структуры и некоторых свойств металлического тория можно найти в оригинальных работах [13–20].

* E-mail: ivanovskii@ihim.uran.ru

В обзоре, наряду со сведениями о зонной структуре, плотностях электронных состояний, характеристиках межатомных связей, зарядовых распределений, мы приводим результаты компьютерного моделирования структурных параметров и параметров фазовой стабильности. Обсуждаются теоретические оценки энергий образования торийсодержащих фаз, существующие методы расчетов их упругих параметров (для моно- и поликристаллических систем), а также рентгеновских эмиссионных, абсорбционных и фотоэлектронных спектров.

1. БИНАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТОРИЯ

В данном разделе будут рассмотрены особенности электронной структуры и некоторые физико-химические свойства бинарных фаз, образующихся при взаимодействии тория с *sp*-элементами.

1.1. Гидриды тория. Интерес к гидридам тория обусловлен перспективами их использования в качестве компонентов ядерного топлива [3], поскольку введение водорода в торий позволяет достичь оптимального нейтронного замедления с относительно низким объемом хладагента. Кроме того, топливо на основе гидрида тория имеет более высокую плотность тяжелого металла, чем традиционные оксидные системы. С другой стороны, богатые по водороду гидриды металлов привлекают внимание как перспективные сверхпроводящие материалы [21, 22]. Например, недавно высказано предположение, что гидриды металлов IV группы при экстремальных давлениях могут переходить в состояние высокотемпературной сверхпроводимости [23]. Среди известных к настоящему дню сверхпроводящих гидридов бинарных металлов [24] богатая по водороду фаза Th_4H_{15} обнаруживает наиболее высокое значение температуры критического перехода $T_c \sim 8 \div 9 \text{ K}$ [25, 26], тогда как другой гидрид тория — ThH_2 не является сверхпроводником вплоть до 1,2 К.

Некоторые физические свойства упомянутых фаз ThH_2 и Th_4H_{15} , образующихся в системе Th—H, описаны в [3]. Дигидрид ThH_2 имеет тетрагональную структуру (пространственная группа $I4/mmm$, $Z = 2$); приводятся также сведения о существовании метастабильной кубической (тип флюорита, пространственная группа $Fm\bar{3}m$) фазы ThH_2 [3]. Структура высшего гидрида Th_4H_{15} (пространственная группа $I-43d$, $Z = 4$) является гораздо более сложной: элементарная ячейка этой фазы включает 16 атомов тория и 60 атомов водорода. Из них 12 атомов H^1 расположены в центрах тетраэдров Th_4 , оставшиеся 48 атомов H^2 находятся в центрах треугольников Th_3 , [3].

Для описания электронных характеристик гидридов Th предложены две феноменологические модели [27, 28]. В первой предполагали, что в гидридах тория происходит частичное заполнение $\text{Th}5f$ -состояний; эта модель привлекалась для описания влияния давления на величину T_c в Th_4H_{15} [27]. Наоборот, авторы [28], исходя из данных экспериментов по фотоэлектронной спектроскопии, полагают, что в приферниевской области доминируют $\text{Th}6d$ -состояния.

Зонная структура кубической (флюоритоподобной) фазы ThH_2 была изучена методом LMTO [29]. Авторы обнаружили частичное заселение $\text{Th}5f$ -состояний за счет их гибридизации с $\text{H}1s$ -орбиталами. Систематический анализ электронных свойств гидридов тория (в ряду $\alpha\text{-Th} \rightarrow \text{ThH}_2$ (тетрагональная (t) и кубическая (c) фазы) \rightarrow и Th_4H_{15}) выполнен недавно в работе [30] методом FLAPW-GGA.

Эволюцию зонной структуры гидридов Th (с ростом H/Th) представляет рис. 1. Видно, что, например, при переходе $\alpha\text{-Th} \rightarrow \text{ThH}_2$ введение атомов водорода в решетку тория обуславливает формирование двух $\text{H}1s$ -подобных зон в области 8,2—3,4 эВ ниже E_F , которые располагаются между квазистабильными зонами $\text{Th}6p$ и приферниевскими $\text{Th}6d,5f$. Эти $\text{H}1s$ -зоны полностью заняты за счет частичного перехода электронов от атомов тория, в результате чего заполненная часть полосы Th в дигидриде оказывается существенно уже (3,2 эВ), чем в металлическом Th (4,8 эВ).

Детали электронных распределений для $\text{ThH}_2(t)$ иллюстрирует рис. 2, где приводится также рентгеновский фотоэлектронный спектр (РФС) валентной полосы дигидрида [28]. Видно, что двухпиковая структура спектра хорошо воспроизводится в расчетах FLAPW-GGA [30].

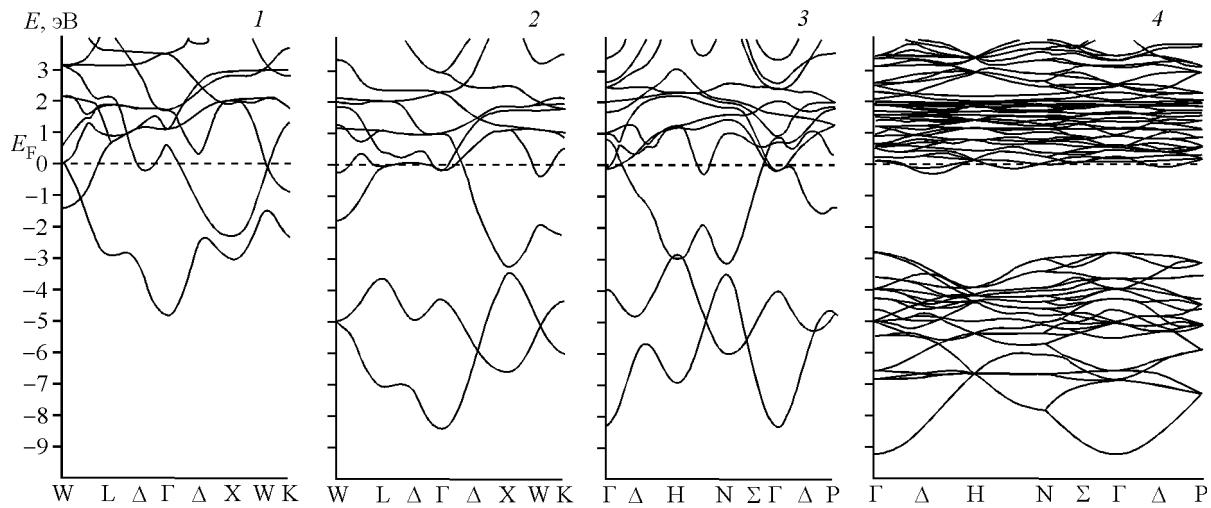


Рис. 1. Энергетические зоны: 1 — α -Th, 2 — $\text{ThH}_2(\text{c})$, 3 — $\text{ThH}_2(\text{t})$ и 4 — Th_4H_{15} . Расчеты FLAPW-GGA [30]

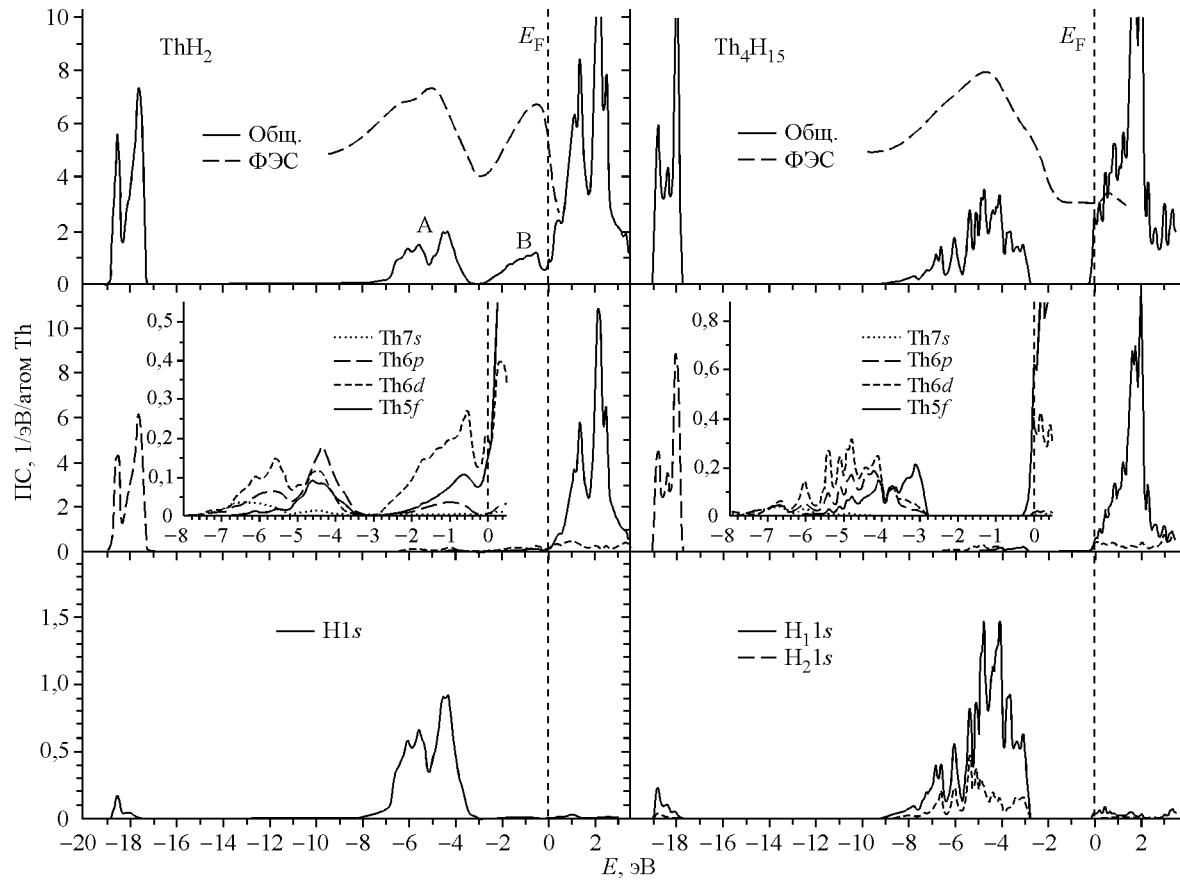


Рис. 2. Полные и парциальные плотности состояний $\text{ThH}_2(\text{t})$ и Th_4H_{15} [30] и фотоэлектронные спектры этих гидридов согласно [38]

Нижний пик *A* соответствует σ -связывающим $\text{H}1s$ — $\text{H}1s$ -взаимодействиям; верхний пик *B* отражает в основном состояния тория. $\text{Th}5f$ -состояния перекрываются с $\text{H}1s$ -зонами и примешиваются к заполненным зонам вблизи E_F ; это указывает на возможность стабилизации дигидридной фазы при некотором понижении электронной концентрации, например, при образова-

ния нестехиометрических составов ThH_{2-x} , когда E_F достигнет минимума плотности состояний (ПС).

При переходе $\text{ThH}_2 \rightarrow \text{Th}_4\text{H}_{15}$ рост содержания водорода приводит к дальнейшему опустошению зон тория и росту ширины $\text{H}1s$ -подобной полосы от 4,8 эВ (TiH_2) до 6,3 эВ (Th_4H_{15}). Уровень Ферми пересекает $\text{Th}6d,5f$ -подобные зоны. Сравнение плотностей состояний [30] с РФС Th_4H_{15} [28] показывает, что наиболее интенсивный спектральный пик (при -5 эВ) формируют состояния атомов H^2 , тогда как состояния атомов H^1 находятся ниже по шкале энергий. Уровень Ферми расположен на крутом склоне ПС, т.е. величина $N(E_F)$ будет весьма чувствительной к изменению стехиометрии образцов Th_4H_{15} (по водороду). Весьма интересным оказывается изменение соотношения вкладов $5f/6d$ состояний Th в ряду $\alpha\text{-Th} \rightarrow \text{ThH}_2 \rightarrow \text{Th}_4\text{H}_{15}$ (табл. 1): для тория эти вклады сравнимы, для дигидрида преобладает вклад $\text{Th}6d$, тогда как для высшего гидрида Th_4H_{15} наиболее значительный (более 50 %) вклад в $N(E_F)$ вносят $\text{Th}5f$ -состояния.

Расчеты [30] констант Зоммерфельда γ (в модели свободных электронов $\gamma^{\text{теор}} = (\pi^2/3) \times N(E_F) k_B^2$, см. табл. 1) показывают, что эта величина максимальна для металлического тория — в согласии с экспериментом [31]. Кроме того, рассчитанные величины γ позволяют оценить константы электрон-фононного взаимодействия (λ) в простом приближении $\gamma^{\text{эксп}} = \gamma^{\text{теор}} (1 + \lambda)$ [32]. Используя для Th_4H_{15} значение $\gamma^{\text{теор}}$ [30] и величину $\gamma^{\text{эксп}}$ по данным калориметрических измерений [31], получаем значение $\lambda \sim 0,38$, что позволяет отнести Th_4H_{15} к сверхпроводникам со слабым типом электрон-фононного взаимодействия.

1.2. Гексаборид тория. При взаимодействии с бором торий образует ряд богатых по бору фаз: ThB_4 – ThB_{66-77} , основу кристаллической решетки которых составляют разнообразные мотивы ковалентно связанных атомов бора: плоские сетки B_5/B_7 (для ThB_4) или полиэдры B_n — для высших боридов тория [33]. Сведения об электронных свойствах боридов тория ограничены. В работе [34] впервые выполнен расчет FLAPW-GGA кубического (тип $B2$, пространственная группа $Pm3m$ [35]) гексаборида ThB_6 . Согласно этим результатам, ThB_6 является немагнитным металлом. Его валентная зона включает преимущественно $2s,2p$ -орбитали бора, организующие три типа взаимодействий: связи B — B в октаэдрах B_6 , связи B — B между соседними октаэдрами B_6 и связи B — Th (рис. 3). Наиболее сильными являются связи B — B в октаэдрах B_6 ; в результате вид валентной ПС ThB_6 оказывается близким таковым для изоструктурных гексаборидов других металлов [36]. В спектре ThB_6 выделяются две полосы, низшая из которых A включает вклады преимущественно $\text{B}2s$ -состояний и отделена от следующей занятой полосы B запрещенной щелью ~0,3 эВ. В свою очередь, полоса B составлена сравнимыми вкладами $\text{B}2s,2p$ с примесью $\text{Th}5f,6d$ -состояний; последние ответственны за образование связей Th — B .

Как можно видеть из карты зарядовой плотности (см. рис. 3), для гексаборида тория ковалентное перекрывание состояний Th — B существенно меньше, чем B — B в октаэдрах B_6 . Это хорошо видно при сравнении профилей зарядовой плотности ρ вдоль линий связей Th — B и B — B (см. рис. 3): значение ρ вдоль линии связи B — B много больше, чем вдоль линии связи Th — B . Кроме того, значение ρ в области перекрывания состояний Th — C оказывается выше, чем в области перекрывания состояний Th — B . Таким образом, основную роль в образовании межатомных связей в ThB_6 играют B — B взаимодействия между атомами бора, входящих в состав октаэдров B_6 , и атомами бора соседних группировок B_6 . Очевидно, "жесткость" подрешетки бора определяет ограниченную область гомогенности ThB_6 (по подрешетке Th).

Таблица 1

Полные, парциальные плотности состояний на уровне Ферми ($N(E_F)$, $N_i(E_F)$, сост./эВ/атом Th) и константы Зоммерфельда γ (кДж К⁻²/моль Th) для $\alpha\text{-Th}$ и гидридов тория согласно расчетам FLAPW-GGA [30]

Система	$N_i(E_F)$			$N(E_F)$	γ
	$\text{Th}6d$	$\text{Th}5f$	$\text{H}1s$		
$\alpha\text{-Th}$	0,261	0,278	—	1,291	3,05
ThH_2 (c)	0,374	0,202	0,002	1,451	3,43
ThH_2 (t)	0,207	0,140	0,001	0,866	2,04
Th_4H_{15}	0,441	0,619	0,049	2,474	5,84

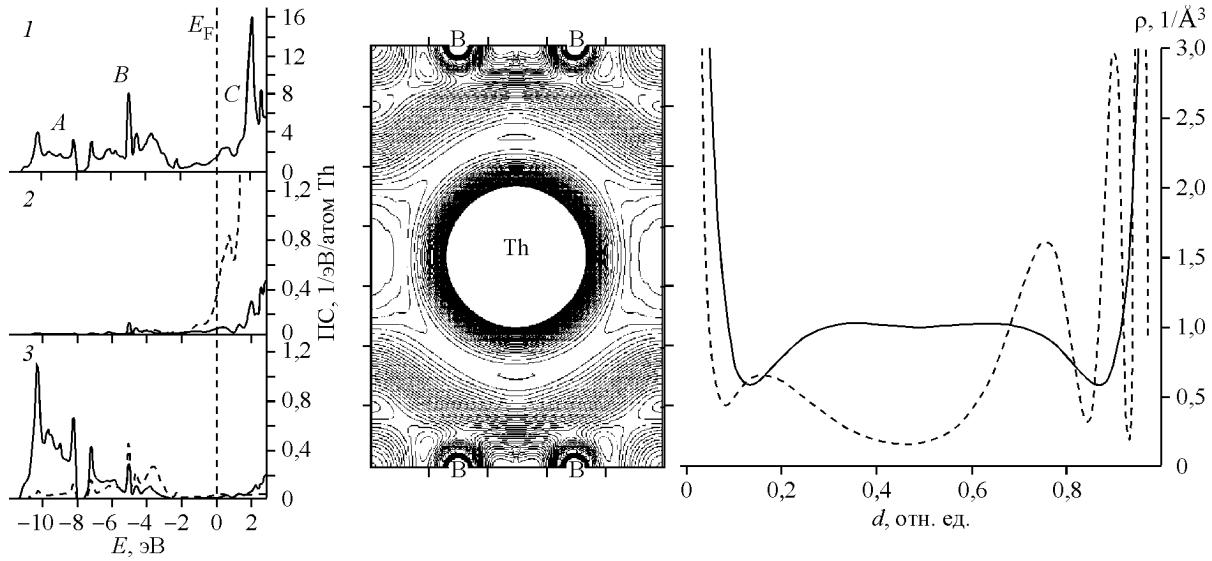


Рис. 3. Слева: полные (1) и атомные (2, 3) плотности состояний ThB_6 . Приведены атомные ПС: (2) тория — $\text{Th}6d$ (точки) и $\text{Th}5f$ (сплошные линии) и (3) бора — $2s$ (сплошные линии) и $2p$ (точки). Справа: карта зарядовой плотности в плоскости сечения (110) и профили распределения зарядовой плотности (ρ) вдоль линий связи Th—B (точки) и B—B (сплошная линия) [34]

В прифермиевской области ThB_6 сосредоточены $\text{Th}6d, 5f$ -состояния, тогда как вклад в $N(E_F)$ состояний бора достаточно невелик, ~33 %. В свою очередь, в составе металлических состояний на уровне Ферми доминируют $\text{Th}5f$ -орбитали. Для ThB_6 коэффициент Зоммерфельда γ составляет около $3,91 \text{ мДж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-2}$, что на 48 % больше, чем у чистого α -Th ($2,65 \text{ мДж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-2}$).

1.3. Карбиды тория. В системе Th—C существуют две основные фазы — моно- (ThC) и дикарбид (ThC_2) [4]. Кубический (типа $B1$) монокарбид тория обладает широкой областью нестехиометрии по углеродной подрешетке ThC_{1-x} ($0 < x < 0,33$). Дикарбид существует в виде трех полиморфных модификаций: α , β и γ . Низкотемпературная моноклинная α фаза включает димеры C_2 (с расстояниями C—C около $1,3 \text{ \AA}$), координированные атомами Th. Промежуточная модификация β — ThC_2 имеет тетрагональную, тогда как высокотемпературная γ -фаза — кубическую структуру.

К настоящему времени наиболее изучен монокарбид тория; ранние модели, предложенные для описания электронных свойств ThC , обобщены в монографии [4]. Недавно проведены расчеты зонной структуры ThC методами LMTO-TB [37] и FLAPW-GGA [34, 38]. Расчетный параметр решетки a_0 ($5,3879 \text{ \AA}$ [18]) воспроизводит экспериментальные данные ($5,335$ — $5,344 \text{ \AA}$ [4]) с точностью до 1,0 %. Полное заполнение углеродом октапозиций ГЦК решетки металлического тория ($a_0(\text{Th}) = 5,084 \text{ \AA}$) при образовании ThC приводит к росту длины связей Th—Th на 6 %. При этом зонные структуры тория и его карбида становятся принципиально различными.

Дисперсионные кривые $B1$ ThC (рис. 4) демонстрируют двухполосную структуру валентного спектра карбида, где нижняя $\text{C}2s$ -зона отделена от группы прифермиевских зон энергетической щелью ~6 эВ. Последние составлены $\text{C}2p$ -орбиталами с примесью $\text{Th}6d, 5f$ -состояний, которые ответственны за организацию ковалентных связей Th—C. Общий характер межатомных взаимодействий в ThC , формируемых системой Th—C (σ -связи за счет перекрывания $\text{Th}6d(e_g)$ — $\text{C}2p$ -орбиталей и π -связи за счет перекрывания $\text{Th}6d(t_{2g})$ — $\text{C}2p$ -орбиталей) и связей Th—Th, иллюстрирует рис. 5.

Особенности электронных распределений в ThC четко проявляются на формах рентгеновского эмиссионного (РЭ) и абсорбционного (РА) K_α -спектров углерода, рассчитанных [38] по методике TELNES [39]. Интенсивность (I) РЭ линий (переходы $2p \rightarrow 1s$ отражают распределение занятых $2p$ -состояний углерода) в дипольной аппроксимации с учетом матричных элементов перехода определяли как

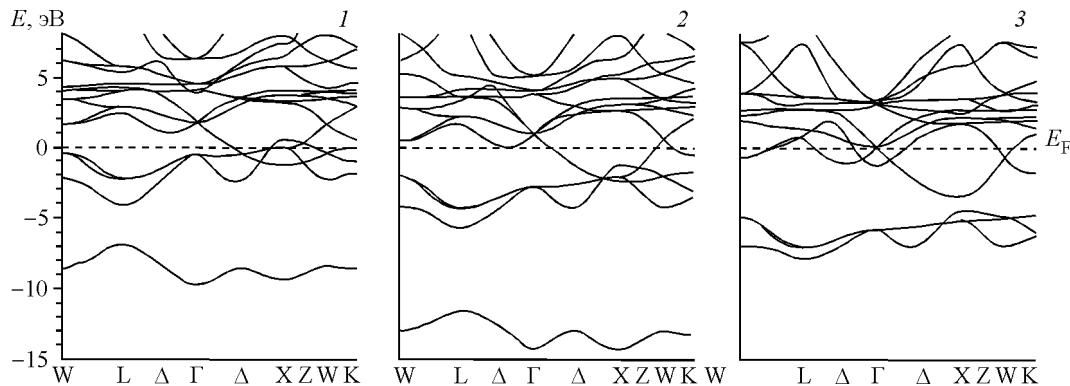
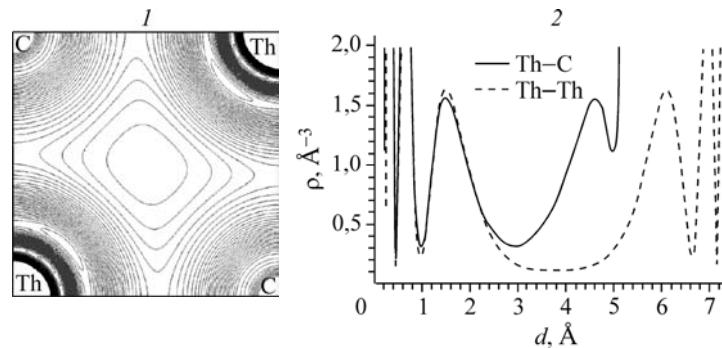
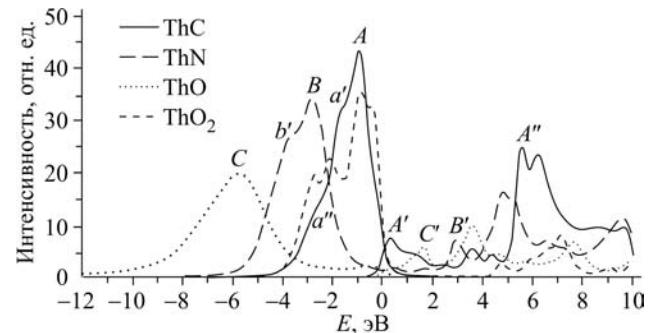


Рис. 4. Энергетические зоны кубических ThC (1), ThN (2) и ThO (3) [38]

Рис. 5. 1 — карта валентной зарядовой плотности ρ в плоскости (100) ThC и 2 — профили распределения ρ вдоль линий связи Th—C и Th—Th [38]Рис. 6. Теоретические (C, N, O) K_{α} -спектры рентгеновской эмиссии и поглощения для кубических ThC, ThN, ThO в сравнении с диоксидом тория [38]

$$I(E, \mathbf{e}) \sim E^3 \sum |\langle f | \mathbf{e} \cdot \mathbf{r} | i \rangle|^2 \delta(E_f + E - E_i),$$

где $\langle i |$ и $| f \rangle$ — вовлеченные в электронные переходы начальное и конечное состояния с энергиями E_i и E_f соответственно.

На профиле эмиссионного K_{α} -спектра, кроме основного максимума A (рис. 6), четко выделяются субструктуры a' и a'' , отражающие особенности гибридизации $C2p$ с $\text{Th}\{6d(e_g), (t_{2g}) + 5f\}$ состояниями [38]. Гораздо более сложным является профиль абсорбционного K_{α} -спектра, связанного с распределением вакантных состояний углерода в полосе проводимости.

Анализ плотности состояний на уровне Ферми [38] показывает (табл. 2), что для ThC активную роль в формировании верхних занятых зон играют f -состояния тория. Так, в составе $N(E_F)$ вклад 5f-орбиталей достигает около 25 % — выше, чем вклад Th6d-орбиталей (~15 %).

Таблица 2

Парциальный состав плотности состояний на уровне Ферми $N(E_F)$ (сост./эВ) для кубических ThC, ThN и ThO согласно расчетам FLMTO-GGA [38]

Фаза	Th6d	Th5f	(C, N, O)2p
ThC	0,051	0,083	0,209
ThN	0,202	0,264	0,066
ThO	0,055	0,112	0,048

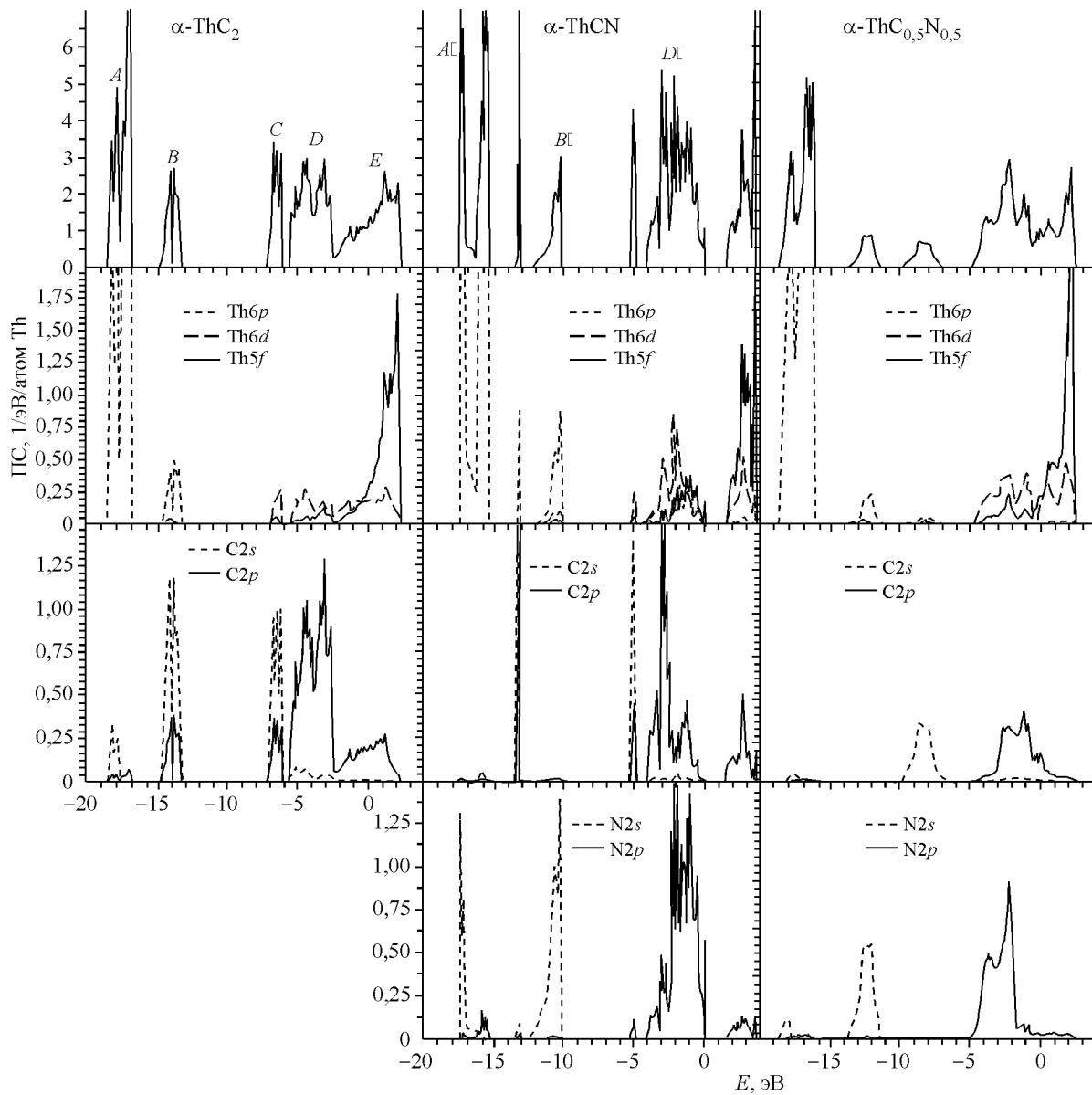


Рис. 7. Полные и парциальные плотности состояний дикарбида (α -ThC₂) и карбонитридов тория — α -ThCN и ThC_{0.5}N_{0.5}. Расчеты методом VASP [40]

Существенно отличается от монокарбида электронная структура другого карбида тория — моноклинной α -фазы ThC₂. По данным [40] валентная полоса ThC₂ включает пять отдельных подполос (рис. 7). Две нижние образованы в основном Th6p- и C2s-состояниями. Следующая заполненная полоса включает вклады C2p-орбиталей, ответственных за образование сильных ковалентных σ -связей в димерах C₂. Две верхние прифермиевские подполосы имеют смешанный тип Th(6d+5f)—C2p. Эти состояния принимают участие в формировании связей Th—C₂ и Th—Th. Дно зоны проводимости образуют в основном Th5f-состояния с примесью Th6d и антисвязывающих C2p-состояний.

Проведена сравнительная оценка стабильности двух карбидов тория [40]. Для этого, взяв в качестве исходных графит C^g и ГЦКТh, для формальных реакций Th + C^g → ThC и Th + 2C^g → ThC₂, оценили энергии их формирования E_f как

$$E_f(\text{ThC}) = E_{\text{tot}}(\text{ThC}) - \{E_{\text{tot}}(\text{Th}) + E_{\text{tot}}(\text{C}^g)\} \quad \text{и}$$

$$E_f(\text{ThC}_2) = E_{\text{tot}}(\text{ThC}_2) - \{E_{\text{tot}}(\text{Th}) + 2E_{\text{tot}}(\text{C}^g)\},$$

где E_{tot} — полные энергии ThC , ThC_2 , Th и C^g , получаемые в зонных расчетах. Получено, что $-E_f(\text{ThC}_2) = 0,75$ эВ (~72,1 кДж/моль) $> -E_f(\text{ThC}) = 0,55$ эВ (~52,9 кДж/моль), т.е. дикарбидная фаза оказывается более устойчивой, чем монокарбид тория. Это согласуется с имеющимися термодинамическими данными [4].

1.4. Нитриды тория. В системе $\text{Th}-\text{N}$ существуют две нитридные фазы: кубический (типа $B1$) мононитрид ThN и высший нитрид Th_3N_4 с ромбоэдрической структурой (кристаллографический тип Al_3C_4) [8]. В настоящее время электронная структура изучена только у простейшего кубического мононитрида тория, для которого рассчитаны зонная структура (см. рис. 4), рентгеновские эмиссионные и абсорбционные NK-спектры (см. рис. 6) [38]. В частности, установлено частичное заселение $\text{Th}5f$ -состояний, которые принимают участие в организации межатомных связей $\text{Th}-\text{N}$ и $\text{Th}-\text{Th}$ и вносят заметный вклад в прифермиеvские зоны (см. табл. 2). Для ThN рассчитан коэффициент Зоммерфельда $\gamma = 2,74 \text{ мДж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-2}$ [38], оказавшийся в разумном согласии с экспериментом ($3,12 \text{ мДж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-2}$ [8]). Недавно метод FLAPW использован для сравнительных оценок энергий формирования E_f (определенный как разность полных энергий нитрида и суммы энергий металла и молекулярного азота) в ряду мононитридов $5f$ -металлов ($\text{Ac}, \text{Th}\dots\text{Am}$) [41]. Заметный рост E_f для ThN и PaN , отклоняющийся от линейной зависимости в ряду других нитридов актинидов, объяснили усилением ковалентной составляющей связи металл—азот в этих нитридах за счет сильной гибридизации $d,f - \text{N}2p$ -состояний [41].

Некоторые дополнительные сведения об электронной структуре ThN приводятся в работах [42—44], где обсуждаются фотоэлектронные спектры тонких пленок [42], молекулярно-динамическое моделирование термических свойств мононитрида [43]. Попытка описать уравнение состояния и оценить объемный модуль упругости ThN в рамках ионной модели предпринята авторами [44].

1.5. Оксиды тория. Среди других соединений тория его оксиды привлекают особое внимание, поскольку являются основными промышленными материалами для использования в ториевых ядерных реакторах [2, 3, 45].

В системе $\text{Th}-\text{O}$ известно два оксида: стабильный диоксид ThO_2 и метастабильная фаза — моноксид ThO . ThO_2 имеет экстремальную (среди всех бинарных оксидов металлов) температуру плавления $T_{\text{пл}} \sim 3660$ К; при высоких температурах состав диоксида может отклоняться от стехиометрического $\text{O}/\text{Th} = 2$, ThO_2 имеет кубическую структуру (тип флюорита, пространственная группа $\text{Fm}3m$, параметр решетки $a = 5,5975 \text{ \AA}$) [3].

Метастабильный моноксид тория кристаллизуется в простой кубической структуре типа $B1$, $a = 5,302 \text{ \AA}$ [46]. Поскольку в равновесных условиях происходит декомпозиция $\text{ThO} \rightarrow \text{Th}(\text{металл}) + \text{ThO}_2$ [47], то получение моноксида тория требует введения в его состав различных стабилизирующих добавок [3, 46].

Ранние модели, предложенные для описания электронных свойств диоксида тория, суммированы в обзоре [48]. В рамках современных методов вычислительной зонной теории электронные свойства метастабильного $B1$ - ThO исследованы в работах [38, 49]. Энергетические зоны ThO (см. рис. 5) демонстрируют типичную для моноксидов металлов двухполосную структуру валентного спектра, где нижняя заполненная полоса шириной 3,2 эВ отделена от прифермиеvской частично занятой полосы (составлена преимущественно $\text{Th}d,f$ -орбиталью) щелью шириной около 1 эВ. Основное отличие структуры валентного спектра ThO от изоструктурных моноксидов d металлов [50] заключается в присутствии в составе заполненных зон $\text{Th}5f$ -состояний (см. табл. 2). По своим электрофизическим свойствам ThO является металлом, его константа Зоммерфельда, по оценкам [38], составляет $\gamma = 1,333 \text{ мДж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-2}$. Теоретический ОК-РЭС спектр ThO , рассчитанный в рамках метода FLAPW-GGA, приведен на рис. 6.

Электронная структура и некоторые свойства ThO_2 описаны в [38, 51—56]. Согласно этим расчетам, диоксид — широкозонный полупроводник; типичная ширина запрещенной щели (ЗЩ), получаемая в рамках LDA расчетных схем, составляет около 3,3 эВ [56], тогда как экспе-

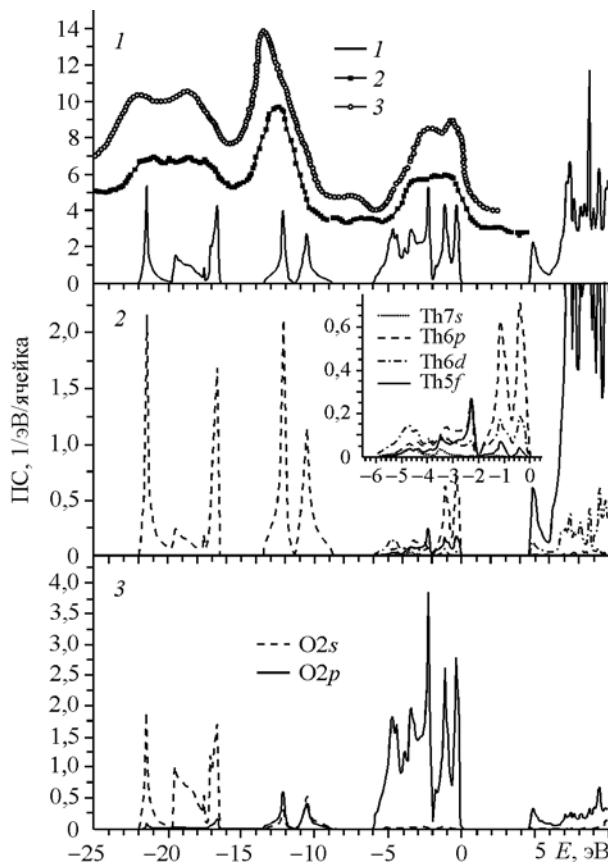


Рис. 8. Полная (вверху) и парциальные плотности состояний диоксида тория ThO_2 согласно расчетам FLAPW-GGA с учетом спин-орбитального взаимодействия. Приведены (1—3) валентные РФС спектры диоксида [48, 57]

риментально оцененная ЗЩ оказывается примерно в 1,6 раза больше (~5 эВ). Это отражает хорошо известный факт занижения величины ЗЩ в методах, использующих приближение теории функционала электронной плотности.

На рис. 8 приведены полная и парциальные плотности состояний диоксида тория согласно расчетам FLAPW-GGA с учетом спин-орбитального взаимодействия. По этим данным, ширина ЗЩ оказалась более близкой к экспериментальной (~4,6 эВ). Кроме того, удалось корректно воспроизвести энергетическое расщепление $\text{Th}6p_{1/2}$ — $\text{Th}6p_{3/2}$ -орбиталей — в хорошем соответствии с рентгеноэлектронными экспериментами [48, 57]. Теоретический ОК-РЭС спектр ThO_2 приведен на рис. 6.

Анализ состава валентных полос указывает на присутствие в области $\text{O}2p$ -состояний

примесей $\text{Th}d,p$ и $5f$ -орбиталей, которые организуют ковалентную составляющую связей Th — O . Кроме того, расчеты свидетельствуют о заметном смешивании квазистабильных $\text{Th}6p$ - и $\text{O}2s$ -состояний, что может служить указанием на их участие в межатомных взаимодействиях в диоксиде тория. Отметим, что данный эффект впервые был отмечен в работах [48, 57] по изучению квазистабильных состояний ThO_2 методом рентгеноэлектронной спектроскопии. Дно зоны проводимости образовано вкладами $\text{Th}6d,5f$ -состояний. Кроме параметров зонной структуры для ThO_2 рассчитывали упругие параметры, в частности, модуль всестороннего сжатия B . Получаемые величины $B \sim 193$ ГПа [56] — 225 ГПа [58] разумно согласуются с имеющимися экспериментальными оценками (см. обзор в [56]).

Более подробно методология расчетов упругих свойств соединений тория будет рассмотрена в следующем разделе на примере бинарных соединений тория с $2p$ — $5p$ -элементами.

1.6. Электронная структура и упругие свойства кубических соединений тория с $2p$ — $5p$ -элементами. Как отмечалось, керамики на основе соединений тория с неметаллами привлекают внимание как перспективные материалы атомной промышленности, в производстве композиционных реакторных и высокопрочных конструкционных материалов. Важный класс этих материалов составляют керамики на основе кубических (типа $B1$, пространственная группа $Fm\bar{3}m$) соединений тория с $2p$ — $5p$ -элементами ThX ($X = \text{C}, \text{N}, \text{O}, \text{P}, \text{S}, \text{As}, \text{Se}, \text{Sb}$). Структурные, энергетические и электронные свойства некоторых из них обсуждались нами ранее.

В то же время технологические перспективы торийсодержащих керамик определяются совокупностью их физико-химических свойств, к важнейшим из которых относятся механические характеристики. Экспериментальные оценки упругих параметров керамик ThX могут заметно отличаться в зависимости от способа их синтеза, пористости, размеров зерен, наличия примесей и т.д. [1—6].

Современные методы компьютерного материаловедения позволяют в рамках единого подхода рассчитать величины упругих параметров серии керамик ThX , что представляется важным как для анализа их изменения в зависимости от состава, так и для прогноза механических

Т а б л и ц а 3

Межатомные расстояния (a , Å), коэффициенты упругости (C_{11} , C_{12} и C_{44} , Па), модули сжатия, сдвига и тетрагонального сдвига (B , G и G' , Па) и коэффициент упругой анизотропии (A) для монокристаллов $B1$ -ThX согласно расчетам FLAPW-GGA [49]

Параметр	ThC	ThN	ThP	ThAs	ThSb	ThO	ThS	ThSe
a (Th—X)	2,650 (2,673)*	2,576 (2,583)	2,933 (2,920)	3,006 (2,986)	3,241 (3,159)	2,556 (2,651)	2,863 (2,842)	2,975 (2,931)
C_{11}	252,2	396,6	273,3	212,4	146,8	331,4	256,5	163,8
C_{12}	96,3	101,5	38,4	35,9	22,1	74,6	68,7	69,3
C_{44} (G)	60,2	79,9	26,1	78,8	28,2	65,4	20,7	25,5
G'	77,9	147,6	117,5	88,25	62,4	128,4	93,9	33,8
B	148,3	199,9	116,7	94,8	63,7	160,2	131,3	100,8
A	0,77	0,54	0,22	0,89	0,45	0,51	0,22	0,54

* В скобках — экспериментальные данные, см. [47].

свойств более сложных по составу легированных торийсодержащих керамик, например, на основе оксинитридов, карбонитридов или оксисульфидов Th [1—3]. В настоящем разделе с использованием результатов работы [49] на примере группы кубических соединений тория с $2p$ — $5p$ -элементами ThX (X = C, N, O, P, S, As, Se, Sb) проиллюстрируем возможности теоретических расчетов упругих параметров для поликристаллического состояния торийсодержащих керамик.

На первом этапе в рамках зонного метода FLAPW-GGA проведены расчеты набора упругих констант C_{ij} монокристаллов ThX [49]. Получено, что величины независимых упругих констант (C_{11} , C_{12} и C_{44} , табл. 3) кубических ThX соответствуют критерию [59] для механически устойчивых кристаллов: $(C_{11} - C_{12}) > 0$; $(C_{11} + 2C_{12}) > 0$; $C_{11} > 0$; $C_{44} > 0$, для которых величины упругих модулей — сжатия ($B = (C_{11} + 2C_{12})/3$), сдвига ($G = C_{44}$) и тетрагонального сдвига ($G' = (C_{11} - C_{12})/2$) положительны. Для ThX $B > G' > G$, т.е. для этих материалов параметром, лимитирующим их стабильность, является модуль сдвига G . Величина коэффициента упругой анизотропии $A = 2G/G' = 2C_{44}/(C_{11} - C_{12})$, который для упруго-изотропных кристаллов равен единице, для ThX фаз меняется в пределах 0,9–0,2, при этом анизотропия минимальна для ThAs (0,89), ThC (0,77) и максимальна для ThP, ThS (0,22). Отклонение от соотношения Коши для упруго-изотропных систем ($C_{12} = C_{44}$) составляет от 48,0 ГПа (ThS) и 42,9 ГПа (ThAs) до 12,2 ГПа (ThP) и 7,1 ГПа (ThSb).

Подчеркнем, что указанные параметры получены на основе расчетов FLAPW-GGA монокристаллов $B1$ -ThX. Для определения макроскопических параметров упругости материалов обычно используют схемы Войгта (V) и Рейусса (R) (см. [60]), в рамках которых модули сжатия определяются как

$$B_{V,R} = \frac{C_{11} + 2C_{12}}{3},$$

а модули сдвига соответственно

$$G_V = \frac{C_{11} - C_{12} + 3C_{44}}{5} \quad \text{и} \quad G_R = \frac{5(C_{11} - C_{12})C_{44}}{4C_{44} + 3(C_{11} - C_{12})}.$$

Для оценок этих параметров для торийсодержащих керамик — поликристаллических систем, представляющих собой агрегированную смесь микрокристаллитов со случайной взаимной ориентацией, — необходимо ввести процедуру усреднения величин, получаемых по схемам Войгта и Рейусса. Для этой цели используют аппроксимацию Войгта—Рейусса—Хилла (VRH) [60], получая величины усредненных модулей сжатия (B_{VRH}) и сдвига (G_{VRH}), затем для ThX керамик определяли модули Юнга (Y_{VRH}):

Т а б л и ц а 4

Упругие параметры поликристаллических керамик ThX: модули сжатия B_{VRH} , сдвига G_{VRH} , Юнга Y_{VRH} , ГПа, коэффициенты сжимаемости β , 1/ГПа, отношение Пуассона ν , коэффициенты Ламэ μ, λ , ГПа в аппроксимации Войгта—Реусса—Хилла (VRH) и число валентных электронов $N(\text{e})$ [49]

Параметр	ThC	ThN	ThP	ThAs	ThSb	ThO	ThS	ThSe
B_{VRH}	148,3	199,9	116,7	94,8	63,7	160,2	131,3	100,8
G_{VRH}	66,7	102,4	50,2	82,4	39,0	86,0	40,1	32,7
ν	0,304	0,281	0,313	0,163				
β	0,006743	0,005003	0,008569	0,010554				
N					0,246	0,272	0,362	0,353
B					0,015708	0,006242	0,007618	0,009924
Y_{VRH}	174,1	262,5	131,8	191,7	97,1	218,8	109,1	88,6
$G_{\text{VRH}}/B_{\text{VRH}}$	0,45	0,51	0,43	0,86	0,62	0,54	0,31	0,33
λ	103,8	131,6	84,0	39,8	37,7	102,9	105,3	79,0
μ	66,7	102,4	50,2	82,4	38,9	85,9	40,0	32,7
$N(\text{e})$	8	9	9	9	9	10	10	10

$$Y_{\text{VRH}} = \frac{9B_{\text{VRH}}G_{\text{VRH}}}{3B_{\text{VRH}} + G_{\text{VRH}}},$$

а также отношения Пуассона (ν) и коэффициенты Ламэ (μ, λ):

$$\nu = \frac{3B_{\text{VRH}} - 2G_{\text{VRH}}}{2(3B_{\text{VRH}} + G_{\text{VRH}})}, \quad \mu = \frac{Y_{\text{VRH}}}{2(1+\nu)}, \quad \lambda = \frac{\nu Y_{\text{VRH}}}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

Указанные параметры всех ThX керамик суммированы в табл. 4. Видно, что, например, для карбидной, нитридной и оксидной керамики модуль B_{VRH} уменьшается в последовательности $B_{\text{VRH}}(\text{ThN}) > B_{\text{VRH}}(\text{ThO}) > B_{\text{VRH}}(\text{ThC})$, что совпадает с известной тенденцией понижения модулей сжатия карбидов Ti, Zr, Hf по сравнению с их нитридами [61]. Зависимость можно объяснить с учетом особенностей межатомных связей в этих материалах. Как отмечено выше, введение в решетку тория p -элементов (C, N и O) приводит к образованию ковалентных связей Th—X, изменению величин связей Th—Th, а также сопровождается зарядовым переносом $\text{Th} \rightarrow \text{X}$, который обуславливает ионную составляющую связи торий—неметалл. Тогда рост модуля сжатия при переходе от ThC к ThN следует отнести за счет упрочнения ковалентных связей Th—X в результате роста электронной концентрации ($N(\text{e})$, в ячейке) при переходе от ThC ($N(\text{e}) = 8\text{e}$) к ThN ($N(\text{e}) = 9\text{e}$) [49]. В свою очередь, уменьшение B_{VRH} при дальнейшем росте $N(\text{e})$ в ряду ThN ($N(\text{e}) = 9\text{e}$) → ThO ($N(\text{e}) = 10\text{e}$) связано с ослаблением связей Th—O по сравнению с Th—N. Соответственно, сжимаемость ThX керамик будет уменьшаться в ряду $\beta(\text{ThC}) > \beta(\text{ThO}) > \beta(\text{ThN})$. Отсюда, исходя из известных корреляций между модулем сжатия (сжимаемостью) и механической прочностью материалов [42], можно утверждать, что максимальной прочностью будет обладать торий-нитридная керамика.

Этот вывод подтверждается расчетами модуля сдвига G_{VRH} (см. табл. 4). Как известно, твердость материала определяют как его сопротивление (которое зависит от подвижности дислокаций) другому материалу, проникающему через его поверхность. Таким образом, один из факторов твердости — прочность межатомных связей по отношению к сдвиговой деформации, определяющей подвижность дислокаций [63]. Для ThX модуль сдвига G_{VRH} понижается (как и B_{VRH}) в последовательности $G_{\text{VRH}}(\text{ThN}) > G_{\text{VRH}}(\text{ThO}) > G_{\text{VRH}}(\text{ThC})$.

В рядах торийсодержащих керамик, для которых $N(\text{e})$ не меняется ($\text{ThN} = \text{TnP} = \text{ThAs}; N(\text{e}) = 10\text{e}$, и $\text{ThO} = \text{ThS} = \text{ThSe}; N(\text{e}) = 11\text{e}$) их упругие параметры зависят от параметра решетки a_0 (длин межатомных связей Th—X, см. табл. 3). Из табл. 4 видно, что модуль сжатия B_{VRH} уменьшается (сжимаемость β растет) в рядах $\text{ThN} \rightarrow \text{TnP} \rightarrow \text{ThAs}$, и $\text{ThO} \rightarrow \text{ThS} \rightarrow \text{ThSe}$,

Рис. 9. Зависимость модулей сжатия B_{VRH} и сдвига G_{VRH} от концентрации валентных электронов $N(e)$ для ThC, ThN и ThO керамик [49]

т.е. с увеличением межатомных расстояний, следя известной тенденции $B_{VRH} \sim 1/V_0$ ($\beta \sim V_0$, где V_0 — объем ячейки). В этой же последовательности уменьшаются величины модуля сдвига G_{VRH} [60].

Отношение Пуассона керамик ThX изменяется обратно пропорционально величинам их приведенных модулей сдвига (G_{VRH}/B_{VRH} , см. табл. 4), которые в свою очередь меняются в интервале от 0,31 (ThS) до 0,86 (ThAs). Наиболее близка к значению G_{VRH}/B_{VRH} изотропного кристалла (0,6) величина $G_{VRH}/B_{VRH} = 0,62$ для ThSb. Для этого материала отношение Пуассона ($v = 0,246$) также оказывается близким к теоретическому для упруго-изотропной среды ($v = 0,25$).

На рис. 9 представлены квадратичные аппроксимации зависимости B_{VRH} и G_{VRH} для ThC, ThN и ThO от числа валентных электронов $N(e)$, экстраполированные до значений $N(e) = 7e$ и $11e$. Видно, что при этих $N(e)$ величины B_{VRH} и G_{VRH} резко уменьшаются (или становятся отрицательными), т.е. соответствующие кубические фазы "ThB" ($N(e) = 7e$) и "ThCl" ($N(e) = 11e$) неустойчивы, что согласуется с экспериментом [1—3]. С другой стороны, максимумы кривых $B_{VRH}(N(e))$ и $G_{VRH}(N(e))$ соответствуют $N(e) = 9,1 - 9,2e$. Отсюда можно прогнозировать, что механические свойства керамики ThN могут быть оптимизированы при введении в ее состав кислорода, т.е. при получении оксинитридной керамики в области составов $\text{ThN} \sim 0,9\text{O} \sim 0,1$.

2. ТРОЙНЫЕ ТОРИЙСОДЕРЖАЩИЕ ФАЗЫ

Многочисленные трехкомпонентные соединения с участием тория можно условно разделить на две основные группы.

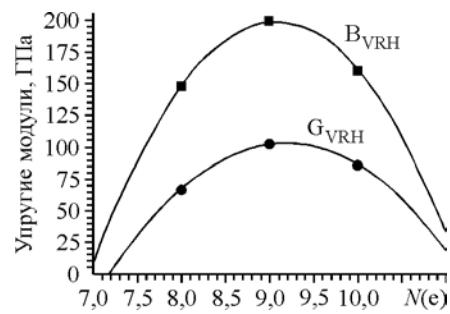
В первую войдут ряды взаимных твердых растворов (TP), которые образованы на основе известных бинарных фаз по типу замещения неметаллических (например, карбонитриды тория $\text{ThC}_x\text{N}_{1-x}$ — твердые растворы в системе ThC—ThN) или металлических атомов (например, так называемые тройные гексабориды $\text{Th}_{1-x}\text{U}_x\text{B}_6$ — твердые растворы в системе ThB_6 — UB_6). Эти TP имеют переменный состав (различают ограниченную и полную взаимную растворимость бинарных компонентов) и в большинстве случаев сохраняют кристаллическую структуру исходных бинарных фаз.

Вторую группу составляют тройные фазы с индивидуальными кристаллическими структурами и химическим составом.

В отличие от бинарных фаз тория, сведения об электронном строении, химической связи и свойствах трехкомпонентных соединений Th гораздо более ограничены.

В данном разделе мы остановимся на обсуждении результатов, иллюстрирующих возможности компьютерного материаловедения в изучении свойств двух упомянутых групп трехкомпонентных торийсодержащих соединений. В качестве примера TP рассмотрены карбонитриды тория. Вторую группу представляют первовскитоподобные фазы — SrThO_3 , TaThN_3 и ортосиликаты тория — хуттонит и торит с общей формулой ThSiO_4 . Отметим, что SrThO_3 представляет интерес как материал, который может образовываться в ядерных реакторах в результате деления радионуклидов, TaThN_3 является единственным известным на сегодняшний день тройным торийсодержащим нитридом со структурой первовскита, а хуттонит и торит (полиморфные модификации ортосиликата тория) — наиболее распространенные в природе торийсодержащие минералы.

2.1. Карбонитриды тория. Как известно, карбонитриды металлов, особенно d -металлов IV и VI групп MC_xN_y (где $x + y \leq 1$), привлекают значительное внимание из-за их экстремальных термомеханических свойств, радиационной, химической стойкости, сочетающихся с интересными электрофизическими и магнитными характеристиками, которые можно направленно



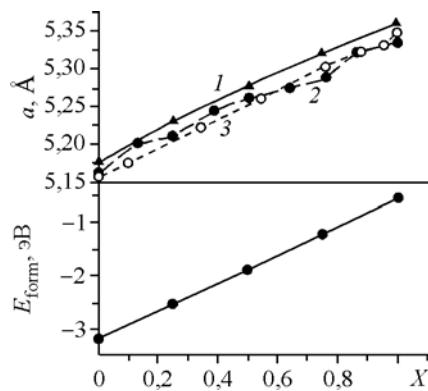


Рис. 10. Вверху: Параметры решетки (1 — расчет [40] и экспериментальные данные: 2 — [79] и 3 — [80]). Внизу: энергии формирования (из простых веществ, см. текст) кубических карбонитридов тория $\text{ThC}_x\text{N}_{1-x}$ как функции содержания азота [40]

78], то относительно карбонитридов f -металлов, и, в частности, тория, имеется гораздо меньше информации.

Подчеркнем, что карбонитридные фазы, образующиеся в системе $\text{Th}—\text{C}—\text{N}$, имеют ряд отличий от карбонитридов d -металлов VI группы: фазовая диаграмма $\text{Th}—\text{C}—\text{N}$ демонстрирует формирование двух типов карбонитридов тория (КНТ) [4]. Один из них представляет собой непрерывный ряд кубических (тип B1) твердых растворов ThC и ThN с октаэдрическим типом окружения каждого атома. Эти ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ ($\text{Th}/(\text{C} + \text{N}) = 1$), в отличие от изоэлектронных карбонитридов d -металлов VI группы, являются сверхпроводниками с максимальной критической температурой $T_c \sim 5,8$ К для состава $\text{ThC}_{0,78}\text{N}_{0,22}$. Другие термохимические и транспортные свойства ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ в зависимости от содержания C/N описаны в [4]. Кроме этих ТР, в системе $\text{Th}—\text{C}—\text{N}$ образуются индивидуальные карбонитридные фазы состава ThCN ($\text{Th}/(\text{C} + \text{N}) = \frac{1}{2}$), которые имеют две полиморфные модификации: низкотемпературную (α) и высокотемпературную (β), с температурой фазового перехода $\alpha \leftrightarrow \beta$ около 1125 К [4]. Кристаллическая структура α - ThCN (моноclinная, пространственная группа $C2/m$, $Z = 4$, параметры решетки $a = 7,022$, $b = 3,946$, $c = 7,279$ Å, $\beta = 95,54^\circ$) имеет слоистый тип, составленный чередованием молекулярных слоев $(\text{Th}—\text{N})/(\text{C}_2)$. Углеродный слой образуют димеры C_2 (как в дикарбиде тория ThC_2) с расстояниями $R(\text{C}—\text{C}) = 1,23$ Å. В слоях $(\text{Th}—\text{N})$ каждый атом азота находится в тетра-окружении атомов тория; в свою очередь, каждый атом Th связан с четырьмя атомами азота и четырьмя атомами углерода. Высокотемпературная β фаза ThCN — гексагональная (пространственная группа $P-31m$, $Z = 6$), параметры решетки $a = 7,035$ и $c = 7,27—7,31$ Å) [4].

В работе [40] с использованием метода VASP—PAW с обменно-корреляционным потенциалом в форме GGA проведен сравнительный анализ электронной структуры и некоторых свойств двух упомянутых групп КНТ: ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$, (при $x = 0,25, 0,5, 0,75$) и α и β фаз ThCN . Были рассчитаны равновесные параметры решетки (a) КНТ $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ во всем диапазоне концентраций C/N, которые демонстрируют близкий к линейному рост a с увеличением содержания азота — в соответствии с правилом Вегарда (рис. 10).

Различия в структуре и химическом составе (отношении $\text{Th}/(\text{C} + \text{N})$) отчетливо проявляются в их электронных спектрах (см. рис. 7). Так, моноclinный α - ThCN является полупроводником с шириной ЗШ около 1,47 эВ. Валентная зона этой фазы включает полосы $A—E$ (подобные аналогичным полосам спектра дикарбida ThC_2 , см. выше), отражающие состояния, участвующие в связях $\text{C}—\text{C}$ (в димерах C_2), $\text{C}—\text{Th}$ и $\text{Th}—\text{Th}$. Кроме того, присутствуют полосы A' , B' и D' , составленные занятymi $\text{N}2s$ - и $\text{N}2p$ -состояниями. $\text{N}2p$ -состояния (в интервале от -2,9 эВ до E_F) гибридизованы с орбиталиами $\text{Th}(6d+5f)$, что свидетельствует о ковалентном связывании $\text{Th}—\text{N}$. Обратим также внимание на примешивание $\text{Th}6p$ - и $\text{N}2s$ -состояний в полосы $\text{N}2s$ - и $\text{Th}6p$ -состояний соответственно, что указывает на участие этих орбиталей в химическом связывании. В целом подобный спектр имеет β -фаза ThCN , для которой ЗШ оказывается большей: 1,97 эВ. Меньшая стабильность β -фазы ThCN (относительно α -фазы) может быть связана с ослаблением системы связей $\text{Th}—\text{C}$ — за счет увеличения межатомных расстояний $\text{Th}—\text{N}$ в кристалле β - ThCN .

варьировать при изменении содержания C/N [64—69]. Например, ТР TiC_xN_y и HfC_xN_y демонстрируют нелинейные зависимости микротвердости и упругих параметров в зависимости от состава неметаллической подрешетки [70—72]. Если для карбонитридов d -металлов соотношения между химическим составом, физико-химическими свойствами и электронным строением изучены достаточно хорошо [68—78], то относительно карбонитридов f -металлов, и, в частности, тория, имеется гораздо меньше информации.

Подчеркнем, что карбонитридные фазы, образующиеся в системе $\text{Th}—\text{C}—\text{N}$, имеют ряд отличий от карбонитридов d -металлов VI группы: фазовая диаграмма $\text{Th}—\text{C}—\text{N}$ демонстрирует формирование двух типов карбонитридов тория (КНТ) [4]. Один из них представляет собой непрерывный ряд кубических (тип B1) твердых растворов ThC и ThN с октаэдрическим типом окружения каждого атома. Эти ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ ($\text{Th}/(\text{C} + \text{N}) = 1$), в отличие от изоэлектронных карбонитридов d -металлов VI группы, являются сверхпроводниками с максимальной критической температурой $T_c \sim 5,8$ К для состава $\text{ThC}_{0,78}\text{N}_{0,22}$. Другие термохимические и транспортные свойства ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ в зависимости от содержания C/N описаны в [4]. Кроме этих ТР, в системе $\text{Th}—\text{C}—\text{N}$ образуются индивидуальные карбонитридные фазы состава ThCN ($\text{Th}/(\text{C} + \text{N}) = \frac{1}{2}$), которые имеют две полиморфные модификации: низкотемпературную (α) и высокотемпературную (β), с температурой фазового перехода $\alpha \leftrightarrow \beta$ около 1125 К [4]. Кристаллическая структура α - ThCN (моноclinная, пространственная группа $C2/m$, $Z = 4$, параметры решетки $a = 7,022$, $b = 3,946$, $c = 7,279$ Å, $\beta = 95,54^\circ$) имеет слоистый тип, составленный чередованием молекулярных слоев $(\text{Th}—\text{N})/(\text{C}_2)$. Углеродный слой образуют димеры C_2 (как в дикарбиде тория ThC_2) с расстояниями $R(\text{C}—\text{C}) = 1,23$ Å. В слоях $(\text{Th}—\text{N})$ каждый атом азота находится в тетра-окружении атомов тория; в свою очередь, каждый атом Th связан с четырьмя атомами азота и четырьмя атомами углерода. Высокотемпературная β фаза ThCN — гексагональная (пространственная группа $P-31m$, $Z = 6$), параметры решетки $a = 7,035$ и $c = 7,27—7,31$ Å) [4].

В работе [40] с использованием метода VASP—PAW с обменно-корреляционным потенциалом в форме GGA проведен сравнительный анализ электронной структуры и некоторых свойств двух упомянутых групп КНТ: ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$, (при $x = 0,25, 0,5, 0,75$) и α и β фаз ThCN . Были рассчитаны равновесные параметры решетки (a) КНТ $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ во всем диапазоне концентраций C/N, которые демонстрируют близкий к линейному рост a с увеличением содержания азота — в соответствии с правилом Вегарда (рис. 10).

Различия в структуре и химическом составе (отношении $\text{Th}/(\text{C} + \text{N})$) отчетливо проявляются в их электронных спектрах (см. рис. 7). Так, моноclinный α - ThCN является полупроводником с шириной ЗШ около 1,47 эВ. Валентная зона этой фазы включает полосы $A—E$ (подобные аналогичным полосам спектра дикарбida ThC_2 , см. выше), отражающие состояния, участвующие в связях $\text{C}—\text{C}$ (в димерах C_2), $\text{C}—\text{Th}$ и $\text{Th}—\text{Th}$. Кроме того, присутствуют полосы A' , B' и D' , составленные занятими $\text{N}2s$ - и $\text{N}2p$ -состояниями. $\text{N}2p$ -состояния (в интервале от -2,9 эВ до E_F) гибридизованы с орбиталиами $\text{Th}(6d+5f)$, что свидетельствует о ковалентном связывании $\text{Th}—\text{N}$. Обратим также внимание на примешивание $\text{Th}6p$ - и $\text{N}2s$ -состояний в полосы $\text{N}2s$ - и $\text{Th}6p$ -состояний соответственно, что указывает на участие этих орбиталей в химическом связывании. В целом подобный спектр имеет β -фаза ThCN , для которой ЗШ оказывается большей: 1,97 эВ. Меньшая стабильность β -фазы ThCN (относительно α -фазы) может быть связана с ослаблением системы связей $\text{Th}—\text{C}$ — за счет увеличения межатомных расстояний $\text{Th}—\text{N}$ в кристалле β - ThCN .

Гораздо более простой вид имеет структура валентной зоны кубических ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$, которая составлена тремя основными полосами ПС, которые разделены энергетическими щелями и составлены $\text{N}2s$ - $\text{C}2s$ - и гибридными ($\text{Th}d,f+\text{N}2p+\text{C}2p$) состояниями (см. рис. 7). Эти ТР по электрофизическим свойствам являются металлами; в плотность состояний на уровне Ферми сравнимый вклад вносят $\text{Th}6d$ - $\text{Th}5f$ - и $\text{C}2p$ -орбитали. В первом приближении спектр кубических ТР $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ можно представить как суперпозицию "взвешенных" вкладов спектров исходных бинарных монокарбида и мононитрида тория. С другой стороны, расчеты [40] обнаружили немонотонную концентрационную зависимость $N(E_F)$ (табл. 5), где приводятся также теоретические оценки параметра Зоммерфельда γ для рассмотренных КНТ.

На примере КНТ рассмотрим возможности вычислительных методов зонной теории для оценок относительной стабильности многокомпонентных фаз, а также для анализа возможных реакций их синтеза.

В настоящее время синтез КНТ $\text{ThC}_{1-x}\text{N}_x$ проводят твердофазным способом с использованием разных реагентов: из смеси $\text{ThC} + \text{ThN}$, смеси ThN и углерода, а также смеси $\text{ThN} + \text{Th} + \text{C}$. Для получения КНТ ThCN используют азотирование ThC или отжиг смеси ThO_2 с углеродом.

Авторы [40] предприняли теоретический анализ теплоты образования КНТ для различных возможных (всего 12) маршрутов их твердофазного синтеза, рассмотрев в качестве "реагентов" металлический торий, углерод (в форме графита), газообразный азот, моно-, дикарбид тория и ThN . Например, взяв в качестве исходных графит (C^g), молекулярный азот N_2 и металлический Th , для формальных реакций $\text{Th} + \text{C}^g + \frac{1}{2}\text{N}_2 \rightarrow \text{ThCN}$ и $2\text{Th} + \text{C}^g + \frac{1}{2}\text{N}_2 \rightarrow 2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}$ энергии формирования КНТ (E_f) можно рассчитать как

$$E_f(\text{ThCN}) = E_{\text{tot}}(\text{ThCN}) - \{E_{\text{tot}}(\text{Th}) + E_{\text{tot}}(\text{C}^g) + \frac{1}{2}E_{\text{tot}}(\text{N}_2)\},$$

$$E_f(\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}) = 2E_{\text{tot}}(\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}) - \{2E_{\text{tot}}(\text{Th}) + E_{\text{tot}}(\text{C}^g) + \frac{1}{2}E_{\text{tot}}(\text{N}_2)\},$$

где E_{tot} — полные энергии ThCN и $\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}$, α - Th , C^g и молекулы N_2 , получаемые в расчетах PAW-VASP. Другие рассмотренные реакции представлены в табл. 6. Отрицательные значения

Таблица 5

Полные ($N(E_F)$) и парциальные плотности состояний на уровне Ферми (сост./эВ·атом) и константы Зоммерфельда γ (кДж/К·моль) для кубических карбонитридов тория в сравнении с ThC и ThN согласно расчетам PAW-VASP [40]

Фаза	$N(E_F)$	$\text{Th}6d$	$\text{Th}5f$	$(\text{C}, \text{N})2p$	γ
ThC	0,956	0,101	0,126	0,218	2,253
$\text{ThC}_{0.75}\text{N}_{0.25}$	0,756	0,122	0,139	0,119, C 0,006, N	1,781
$\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}$	1,032	0,216	0,219	0,117, C 0,022, N	2,432
$\text{ThC}_{0.25}\text{N}_{0.75}$	0,871	0,247	0,222	0,034, C 0,027, N	2,059
ThN	1,137	0,303	0,325	0,053	2,680
ThC_2	0,499	0,071	0,104	0,082	1,244

Таблица 6

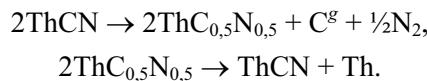
Энергии формирования (E_f , эВ/атом Th) карбонитридов $\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}$ и α - ThCN при различных возможных реакциях их синтеза. Оценки методом PAW-VASP [40]

α - ThCN (моноclinный)		$\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5}$ (кубический)	
Формальная реакция	E_f	Формальная реакция	E_f
$\text{ThCN} \rightarrow \text{Th} + \text{C}^g + \frac{1}{2}\text{N}_2$	-2,84	$2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} \rightarrow 2\text{Th} + \text{C}^g + \frac{1}{2}\text{N}_2$	-1,88
$\text{ThCN} \rightarrow \text{ThC} + \frac{1}{2}\text{N}_2$	-2,29	$2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} \rightarrow \text{ThC} + \frac{1}{2}\text{N}_2 + \text{Th}$	-1,61
$\text{ThCN} \rightarrow \text{ThN} + \text{C}^g$	+0,32	$2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} \rightarrow \text{ThC} + \text{ThN}$	-0,03
$2\text{ThCN} \rightarrow \text{ThC}_2 + \text{N}_2 + \text{Th}$	-2,42	$4\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} \rightarrow \text{ThC}_2 + \text{N}_2 + 3\text{Th}$	-1,64
$2\text{ThCN} \rightarrow \text{ThC}_2 + \text{ThN} + \frac{1}{2}\text{N}_2$	-0,84	$2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} \rightarrow \text{ThN} + \text{C}^g + \text{Th}$	-0,31
$2\text{ThCN} \rightarrow 2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} + \text{C}^g + \frac{1}{2}\text{N}_2$	-0,95	$2\text{ThC}_{0.5}\text{N}_{0.5} \rightarrow \text{ThCN} + \text{Th}$	-0,47

E_f свидетельствуют об энергетической выгодности образования тройной фазы — в сравнении с механической смесью исходных веществ (т.е. о возможности синтеза КТВ по рассматриваемой реакции), и наоборот, если $E_f > 0$, то формирование КТВ из исходных реагентов при обычных условиях будет невыгодным.

Из данных табл. 6 видно, что образование всех КНТ (ThCN и $\text{ThC}_{0,5}\text{N}_{0,5}$) будет наиболее энергетически выгодным из простых веществ (тория, графита и азота), а наименее вероятным будет их получение с использованием нитрида тория. Этот факт связан с максимальной стабильностью ThN : согласно оценкам [40], $-E_f(\text{ThN}) = 3,51$ эВ ($\sim 337,5$ кДж/моль) $> -E_f(\text{ThC}_2) = 0,75$ эВ ($\sim 72,1$ кДж/моль) $> -E_f(\text{ThC}) = 0,55$ эВ ($\sim 52,9$ кДж/моль). Наиболее отчетливо это проявляется для модельной реакции $\text{ThCN} \rightarrow \text{ThN} + \text{C}^g$, для которой расчет E_f ThCN дает положительную величину (+0,32 эВ/атом). Это значит, что фаза $\alpha\text{-ThCN}$ является нестабильной (при $P = 0$ и $T = 0$) относительно смеси $\text{ThN} +$ графит.

Оценки теплоты образования кубических КНТ в области их гомогенности обнаружили монотонный рост $|E_f|$ с увеличением отношения C/N (см. рис. 10). Кроме того, при сравнении $|E_f|$ различных КНТ обнаружено, что $|E_f(\text{ThCN})| > |E_f(\text{ThC}_{0,5}\text{N}_{0,5})|$, т.е. при равном содержании C/N = 1 моноклинная фаза $\alpha\text{-ThCN}$ является более стабильной, чем кубическая $\text{ThC}_{0,5}\text{N}_{0,5}$ — в согласии с термодинамическими данными [4]. Наконец, проведен анализ возможности получения КНТ (моноклинного или кубического) с использованием в качестве реагента другого КНТ (кубического или моноклинного) [20] по реакциям:



Для обеих реакций $E_f < 0$, т.е. эти процессы принципиально осуществимы. При этом, с учетом повышенной стабильности моноклинного КНТ, его синтез из кубического КНТ будет более энергетически выгодным, чем получение $\text{ThC}_{0,5}\text{N}_{0,5}$ из фазы $\alpha\text{-ThCN}$.

Представленный материал позволяет подчеркнуть, что современные методы вычислительной зонной теории оказываются весьма плодотворными для численных оценок энергетических величин, характеризующих химические взаимодействия в твердофазных системах, и могут успешно применяться для анализа различных способов синтеза многокомпонентных фаз, оценок их относительной стабильности, а также их взаимных превращений.

2.2. Соединения тория со структурой перовскита. Достаточно большую группу образуют тройные торийсодержащие соединения со структурой типа перовскита [81]. Среди них особое внимание привлекают оксидные фазы — перовскиты MThO_3 и родственные тройные оксиды M_2ThO_3 . В частности, эти фазы могут формироваться в реакторах, использующих топливные ячейки $(\text{Th—U})\text{O}_2$ или $(\text{Th—Pu})\text{O}_2$ — при взаимодействии ThO_2 с продуктами расщепления радиоактивных изотопов: щелочными и щелочноземельными металлами $\text{M} = \text{Rb}, \text{Cs}, \text{Sr}, \text{Ba}$. При этом формирование в матрице ThO_2 перовскитоподобных торатов $\text{MThO}_3, \text{M}_2\text{ThO}_3$ с увеличенными объемами элементарных ячеек может привести к ее локальным деформациям и, в конечном счете, к разрушению. Поэтому изучению термодинамических свойств торатов, в частности, проблеме стабильности SrThO_3 в последнее время уделяется значительное внимание [82—86].

Как известно, устойчивость перовскитоподобных фаз обычно соотносят с фактором толерантности (t) Гольдшмидта [85, 87], учитывающего условия плотнейшей упаковки сферических ионов. Так, для перовскитов $\text{MM}'\text{O}_3$ $t = (R_{\text{M}} + R_{\text{O}})/\sqrt{2}(R_{\text{M}'} + R_{\text{O}})$. Для устойчивых фаз SrMO_3 фактор t меняется в интервале от 1,0 до 0,8, тогда как для SrThO_3 $t = 0,780$, т.е. торат стронция находится вблизи нижней границы фазовой стабильности [88, 89].

Впервые изучение зонной структуры, некоторых свойств, а также теоретическая оценка фазовой стабильности SrThO_3 в сравнении со стабильным перовскитом SrZrO_3 (цирконий является одним из основных конструкционных материалов ядерных реакторов) и ThO_2 предприняты авторами [56] в рамках метода FLAPW-GGA. Определены параметры основного состояния кубических SrThO_3 и SrZrO_3 : постоянные решетки a и рассчитаны упругие константы C_{ij}

Т а б л и ц а 7

Величины равновесных параметров решетки (a , нм), упругих констант (C_{ij} , ГПа), модуля всестороннего сжатия (B , ГПа), сжимаемости ($\beta = 1/B$, Гпа $^{-1}$), модулей: сдвига (G , ГПа), Юнга (Y , ГПа), отношения Пуассона (ν) для кубических перовскитов SrThO₃ и SrZrO₃ согласно расчетам FLAPW-GGA [56] в сравнении с имеющимися теоретическими и экспериментальными данными

Параметр * , **	SrThO ₃	SrZrO ₃
Параметр решетки a	0,45426	0,41578 (0,4154 [90]; 0,4109 [91]; 0,417 [92])
Упругие константы C_{11}	197,3	368,1 (355 [93])
	67,1	105,2 (106 [93])
	31,9	75,6 (54 [93])
	110,5	153,6; (160 [92]; 171 [94])
Сжимаемость (VRH)	0,00905	0,00651
Модуль сдвига	45,2 (V); 40,1(R); 42,7 (VRH)	93,7 (V); 88,9 (R); 91,3 (VRH); (100 [92]; 98,5 [95])
Модуль Юнга (VRH)	113,4	226,6 (248 [92]; 269 [95])
Отношение Пуассона (VRH)	0,329	0,252

* Имеющиеся данные приведены в скобках.

** Приведены расчетные величины для монокристаллического (в схемах Войгдта (V) и Рейсса (R)) и поликристаллического (в аппроксимации Войгдта—Реусса—Хилла (VRH)) состояний перовскитов.

(табл. 7). Получено, что a для SrThO₃ на ~9,2 % больше, чем a (SrZrO₃), что отражает различия радиусов катионов: $R(\text{Zr}^{4+}) = 0,72 \text{ \AA} < R(\text{Th}^{4+}) = 0,92 \text{ \AA}$. Обе кубические фазы SrThO₃ и SrZrO₃ удовлетворяют общему критерию [59] механической стабильности кубических кристаллов (см. раздел 1.6), однако расчеты свидетельствуют, что SrThO₃ будет менее устойчив к деформациям сдвига и сжатия, поскольку его упругие коэффициенты C_{11} и C_{44} на 117,2 и 43,7 ГПа меньше, чем для SrZrO₃. Оценки упругих параметров для поликристаллического состояния этих перовскитов (в рамках упоминавшейся схемы VRH, см. табл. 7) показали, что при переходе от SrThO₃ к SrZrO₃ (т.е. с уменьшением радиуса катиона M⁴⁺) модули всестороннего сжатия B , сдвига G и Юнга Y уменьшаются соответственно, сжимаемость β возрастает, т.е. SrThO₃ будет обладать меньшей твердостью, чем цирконат стронция.

Для определения относительной устойчивости кубических фаз SrZrO₃ и SrThO₃ рассчитали [56] разницу энергий ΔE_{tot} между SrMO₃ (где M = Zr, Th) и смесью соответствующих бинарных оксидов: $\Delta E_{\text{tot}} = E_{\text{tot}}(\text{SrMO}_3) - \{E_{\text{tot}}(\text{MO}_2) + E_{\text{tot}}(\text{SrO})\}$, где E_{tot} — полные энергии перовскитов, ThO₂, моноклинного ZrO₂ и кубического SrO, полученные рамках единой расчетной схемы FLAPW-GGA. Величины ΔE_{tot} составили: -0,507 и +1,440 эВ/(форм.ед.) для SrZrO₃ и SrThO₃ соответственно, т.е. при условии $P = 0$ и $T = 0$ SrThO₃ метастабилен по отношению к смеси оксидов тория и стронция, и основную роль в формировании тората стронция в реальных условиях должны играть термодинамический и кинетический факторы. Кроме того, стабилизация SrThO₃ возможна за счет искажений идеальной кубической решетки тората, например, с образованием моноклинной фазы, а также за счет различных легирующих добавок [56].

Валентный спектр SrThO₃ (рис. 11) включает три основные полосы, составленные в основном орбиталями (O2s + Sr4p), Th6p и O2p (с примесью Th5f,6d-орбиталей); ширина LDA щели составляет около 2,25 эВ. Нижний край зоны проводимости образован Th 5f,6d-состояниями. Из распределения плотностей состояний видно, что ковалентный вклад в межатомное связывание в торате обеспечен гибридизацией O2p — Th6d,5f-орбиталей, тогда как стронций присутствует в кристалле в ионной форме Sr²⁺ (см. также карту зарядовой плотности на рис. 11).

На рис. 12 приводятся теоретические формы OK _{α} РЭС линий для SrThO₃ в сравнении с ThO₂ [56]. Видно, что спектральные линии тората и диоксида тория существенно различают-

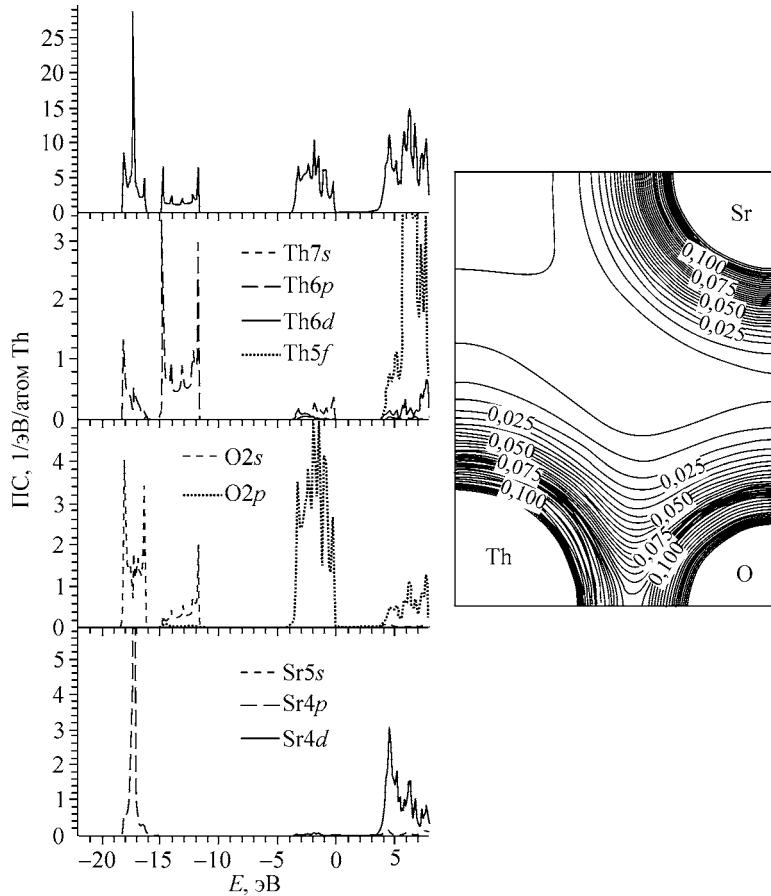


Рис. 11. Полные, парциальные плотности состояний и карта электронной плотности (в плоскости (110), интервалы между контурами в $e/(ат. ед.)^3$) для кубического перовскита $SrThO_3$ [56]

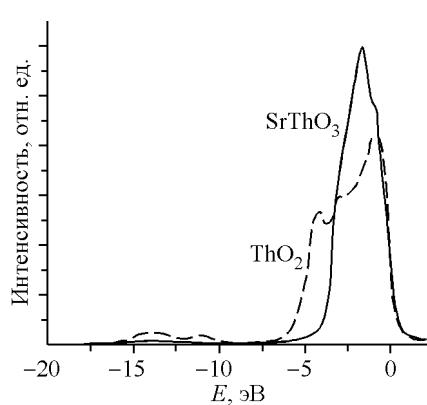


Рис. 12. Теоретические OK_{α} рентгеновские эмиссионные спектры ThO_2 и $SrThO_3$ [56]

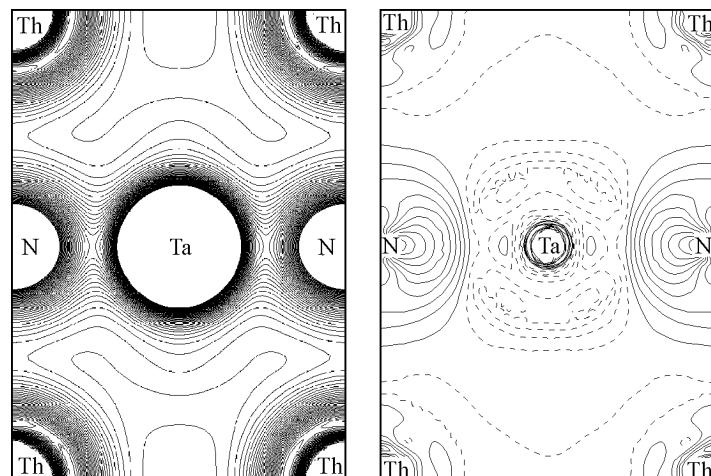


Рис. 13. Зарядовые плотности перовскита $TaThN_3$ в плоскости (110): полная (слева) и дифференциальная (справа). Интервал между контурами $0.05 e/\text{\AA}^3$. Сплошные (штриховые) контуры соответствуют положительным (отрицательным) значениям дифференциальной зарядовой плотности. Расчет методом FLAPW-GGA [98]

ся. Например, основной пик A для ThO_2 заметно (на ~2 эВ) уширен и содержит (в сравнении с OK_{α} спектром $SrThO_3$) дополнительные максимумы A' , A'' , B' и B'' . Эти результаты позволяют

утверждать, что РЭС может стать эффективным методом для фазового анализа топливных материалов на основе ThO_2 .

Другая перовскитоподобная торийсодержащая система, привлекшая недавно внимание, — тройной нитрид TaThN_3 [96]. Эта фаза принадлежит достаточно ограниченной группе кубических перовскитоподобных нитридов общего состава $\text{MM}'\text{N}_3$, в составе которых катионы $\text{M}—\text{M}'$ присутствуют в высоких степенях окисления: (1—8), (2—7), (3—6) и (4—5) [96, 97]. Первые сведения о свойствах TaThN_3 получены недавно [98]. Согласно результатам этих расчетов FLAPW-GGA, TaThN_3 — полупроводник с величиной ЗЩ (примой переход в точке Г) около 0,4 эВ. Весьма нестандартной в TaThN_3 оказывается система межатомных взаимодействий. В отличие от идеальной ионной модели, предполагающей ионные состояния Th^{4+} , Ta^{5+} и N^{3-} , анализ парциальных ПС показал, что существует заметное ковалентное смешивание валентных $\text{Ta}5d$ - $\text{N}2p$ -орбиталей [98]. С другой стороны, орбитали тория $6d$ и $5f$ вакантны и располагаются в зоне проводимости, т.е. атомы Th в решетке TaThN_3 находятся в катионной форме Th^{4+} . В результате, для перовскита TaThN_3 четко выделяются два типа связи азота с разными металлами: ионная связь Th—N и ковалентно-ионная связь Ta—N. Это наглядно прослеживается на картах полной (ρ_{cryst}) и дифференциальной ($\Delta\rho = \rho_{\text{cryst}} - \sum \rho_{\text{at}}$) зарядовых плотностей, рис. 13. Расчеты параметров упругости показали, что для TaThN_3 $B > G' > G$, т.е. параметром, лимитирующим механическую устойчивость перовскита, является модуль сдвига G . В сравнении с бинарным нитридом тория ThN перовскит TaThN_3 более устойчив к деформационным напряжениям и имеет более высокие модули объемного сжатия ($B = 0,59$ ГПа) и Юнга ($Y = 350$ ГПа). Основываясь на известных корреляциях между упругими модулями и твердостью материалов, предполагают [98], что TaThN_3 будет проявлять большую твердость, чем мононитрид тория.

2.3. Силикаты тория: торит и хуттонит. В настоящем разделе рассмотрены имеющиеся сведения о электронной структуре еще одного тройного соединения тория — ортосиликата ThSiO_4 , привлекающего внимание по нескольким причинам. Во-первых, ортосиликат тория — известный акцессорный минерал, присутствующий во многих магматических, осадочных и метаморфических горных породах, что делает его интересным объектом геохимических, геофизических и геохронологических исследований [99, 100]. Как известно, основными минералами — источниками тория, которые включают до 93, 77 и 10 % диоксида тория ThO_2 , являются, соответственно, торианит (*thorianite* $(\text{Th},\text{U})\text{O}_2$), торит (*thorite* — ThSiO_4) и монацит. Последний представляет собой сложный твердый раствор по крайней мере четырех основных компонентов: "чистого" монацита (*monazite* $\text{M}(\text{PO}_4)_2$, где M — редкоземельные элементы), брабанита (*brabantite* $\text{CaTh}(\text{PO}_4)_2$), хуттонита (*huttonite* ThSiO_4) и уранового аналога последнего (USiO_4) [99]. Основным продуктом обогащения этого сырья является диоксид тория ThO_2 .

С другой стороны, ThSiO_4 — одно из немногих индивидуальных соединений, образующихся в тройных системах $\text{Th}—\text{X}—\text{O}$, где X — элементы IVA подгруппы. Ортосиликат тория может быть получен твердофазным синтезом из бинарных оксидов ($\text{ThO}_2 + \text{SiO}_2$), гидротермальным методом или в солевых расплавах [2].

Упомянутые минералы торит и хуттонит представляют собой тетрагональную и моноклинную полиморфные модификации ортосиликата тория, обозначаемые далее как $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ и $\text{ThSiO}_4^{(m)}$. $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ изоструктурен циркону (ZrSiO_4 , пространственная группа $I41/amd$) и содержит тетра-координированные атомы кремния $\{\text{SiO}_4\}$ и восемикратно координированные атомы тория $\{\text{ThO}_8\}$. Моноклинная структура (пространственная группа $P21/n$) хуттонита $\text{ThSiO}_4^{(m)}$ может быть представлена как модифицированная структура $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ с введенным в координационный полиэдр тория девятым атомом кислорода [101—103].

Недавно зонная структура, а также ряд свойств $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ и $\text{ThSiO}_4^{(m)}$ были рассмотрены с привлечением методов FLMTO [104] и FLAPW-GGA [105, 106]. В частности, проведены оценки стабильности этих полиморфов. Их интересной особенностью является тот факт, что $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ — высокосимметричная фаза, она является более устойчивой и переходит в более

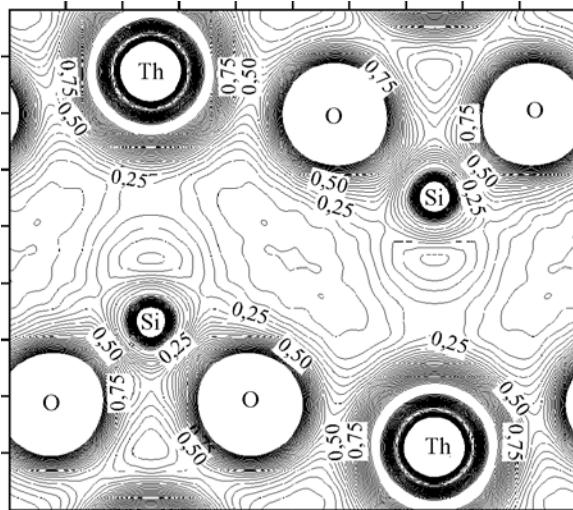


Рис. 14. Зарядовая плотность тетрагонального ThSiO_3 (*торит*). Значения ρ на контурах в $\text{e}/\text{\AA}^3$. Расчет методом FLMTO [104]

низкосимметричную модификацию $\text{ThSiO}_4^{(m)}$ при $T \sim 1480$ К [107], что является исключением из общего правила, согласно которому с ростом температуры реализуются менее плотные и более высокосимметричные полиморфные модификации. С другой стороны, торит и хуттонит присутствуют исключительно в виде включений в магматические и метаморфические горные породы, что позволяет предположить метастабильный характер этих фаз относительно бинарных оксидов — SiO_2 (α -кварц) и ThO_2 [103, 107—109].

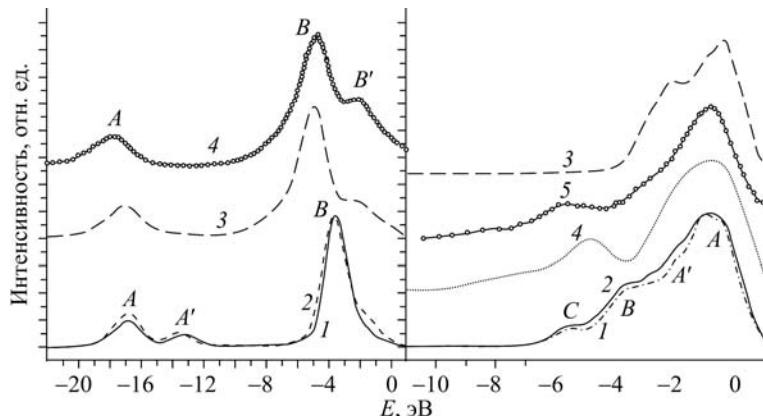
Оценивая относительную стабильность фаз $\text{ThSiO}_4^{(t,m)}$ как $\Delta E_{\text{tot}} = \{E_{\text{tot}}(\text{ThSiO}_4^{(t)}) - E_{\text{tot}}(\text{ThSiO}_4^{(m)})\}$, где E_{tot} — полные энергии систем, получаемые в зонных расчетах, получили величину $\Delta E_{\text{tot}} = -0,0533$ эВ/форм.ед. ($-5,1434$ кДж/моль) [106]; иными словами, при условии $P = 0$ и $T = 0$ тетрагональная фаза более стабильна, чем моноклинная. Подчеркнем, что теоретическая оценка этой величины оказалась близка к экспериментальной ($\Delta H \sim 6,7 \pm 2,5$ кДж/моль), полученной методом высокотемпературной калориметрии [103].

Были проведены также расчеты стабильности каждого полиморфа: $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ и $\text{ThSiO}_4^{(m)}$ относительно бинарных оксидов: ThO_2 и SiO_2 в формальной реакции $\text{ThSiO}_4^{(t,m)} \leftrightarrow \text{ThO}_2 + \text{SiO}_2$ [106]. Для этой цели рассчитывали энергию их формирования как $\Delta E_{\text{form}} = E_{\text{tot}}(\text{ThSiO}_4^{(t,m)}) - \{E_{\text{tot}}(\text{ThO}_2) + E_{\text{tot}}(\text{SiO}_2)\}$. Получено, что для обоих силикатов тория величины ΔE_{form} малы, но положительны: $+0,026$ эВ/форм.ед. ($\sim 2,5$ кДж/моль) и $+0,079$ эВ/форм.ед. ($\sim 7,6$ кДж/моль) для $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ и $\text{ThSiO}_4^{(m)}$ соответственно. Таким образом, расчеты [106] свидетельствуют, что при $P = 0$, $T = 0$ оба силиката тория метастабильны по отношению к смеси простых оксидов. Действительно, согласно многочисленным данным (см., например, [110]), в горных породах торит и хуттонит всегда присутствуют одновременно с кварцем и торианитом.

Проведен детальный анализ электронной структуры $\text{ThSiO}_4^{(t)}$ и $\text{ThSiO}_4^{(m)}$ [104—106]. Оба силиката являются полупроводниками с величинами ЗШ (в LDA аппроксимации) около 4,9 эВ ($\text{ThSiO}_4^{(t)}$) и 4,7 эВ ($\text{ThSiO}_4^{(m)}$). Эти величины близки значению ЗШ ThO_2 (4,75 эВ), но много меньше, чем для α -кварца (5,61 эВ). С учетом поправочного коэффициента [111] оценены "экспериментальные" значения ЗШ силикатов, составившие 7,8 ($\text{ThSiO}_4^{(t)}$) и 7,6 эВ ($\text{ThSiO}_4^{(m)}$) [106].

Химическая связь в торите включает существенную ковалентную составляющую — за счет гибридизации $\text{O}2p$ -орбиталей с $\text{Si}3s, 3p, 3d$ - и $\text{Th}6d, 5f$ -орбиталями в координационных полиэдрах $\{\text{SiO}_4\}$ и $\{\text{ThO}_8\}$ соответственно (рис. 14), т.е. тип межатомных взаимодействий в силикате тория резко отличен от принимаемых в ионной модели, предполагающей исключительно электростатические взаимодействия между Th^{4+} и $(\text{SiO}_4)^4$. Иными словами, электронная конфигурация тория далека от таковой для его катионной формы $5f^0 6d^0$. Сходная картина химических связей присуща хуттониту [106].

Рис. 15. Слева: Теоретические SiK β РЭС спектры торита (1), хуттонита (2) и α -кварца (3) [106]; приведен также экспериментальный SiK β спектр кварца (4) [112]. *Справа:* Теоретические OK α РЭС спектры торита (1), хуттонита (2), ThO₂ (3) и α -кварца (4) [56]; приведен экспериментальный OK α спектр кварца (5) [113]



Построены теоретические формы OK α ($2p \rightarrow 1s$ переход) и SiK β ($3p \rightarrow 1s$ переход) рентгеновских эмиссионных линий для полиморфов ThSiO₄^(t) и ThSiO₄^(m) [106], которые сопоставлены на рис. 15 с аналогичными РЭС линиями кварца и ThO₂. Их рассмотрение [106] позволяет, в частности, заключить, что обе спектральные РЭС линии силикатов тория имеют существенные отличия от соответствующих спектров бинарных оксидов, т.е. РЭС будет являться эффективным методом для анализа состава образцов торийсодержащих минералов, позволяя идентифицировать присутствие в них как ортосиликатов тория, так и сопутствующих оксидов тория и кремния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К настоящему времени наиболее подробно изучены электронные свойства и природа межатомных взаимодействий для бинарных соединений тория с *sp*-неметаллами в системах Th—X, где X = H, B, C, N, O, P, S, As, Se, Sb. Быстро развиваются исследования в области компьютерного материаловедения, направленные на теоретическое моделирование механических (упругие константы, объемные модули, модули Юнга и др.) свойств этих фаз, в том числе, для поликристаллических керамик ThX. Важным шагом к развитию представлений о фундаментальных свойствах сложных многокомпонентных торийсодержащих материалов являются работы последних лет по первопринципным расчетам энергий их формирования и условий фазовых равновесий.

Представленные в обзоре данные составляют основу для постановки работ, направленных на выяснение роли влияния легирования и нестехиометрии на свойства торийсодержащих соединений, а также для систематического анализа их поверхностных состояний. Представляется, что с помощью современных вычислительных методов компьютерного материаловедения быстрый прогресс в развитии представлений об этих важных материалах может быть достигнут в ближайшее время.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 06-08-00808).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Freeman A.J., Lander G.H. (Eds.), *Handbook of the Physics and Chemistry of the Actinides*. – Amsterdam: North—Holland, 1985.
2. Keller C. Thorium. Ternare and polynare Oxide des Thoriums. *Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie*. – Berlin—Heidelberg — N. Y.: Springer, 1976.
3. Keller C. Thorium. Verbindungen mit Edelgasen, Wasserstoff, Sauerstoff. *Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie*. Teil C1. – Berlin—Heidelberg — N. Y.: Springer, 1978.
4. Kleykamp H. Thorium Carbides. *Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry*, Thorium Supplement, V. 6. – Berlin: Springer, 1992.

5. *Bickel M., Wedemeyer H.* Thorium. Compounds with Si, P, As, Sb, Bi, Ge. Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry. Thorium Supplement, V. 8. – Berlin: Springer, 1986.
6. *Brown D., Wedemeyer H.* Thorium. Compounds with S, Se, Te and B. Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry. Thorium Supplement, V. 5. – Berlin: Springer, 1993.
7. *Nigel P., Geckes H., Holloway J.H.* Thorium. Compounds with F, Cl, Br, I. Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry. Thorium Supplement, V. 3. – Berlin: Springer, 1993.
8. *Benz R., Naoumidis A.* Thorium, Compounds with Nitrogen, Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry: 8th Edition, Thorium Supplement, V. C3. – Berlin: Springer, 1987.
9. *Vajeeston P., Vidya R., Ravindran P. et al.* // Phys. Rev. – 2002. – **B65**, N 7. – art. 075101.
10. *Soderlind P., Eriksson O.* // Ibid. – 1999. – **B60**, N 13. – P. 9372 – 9376.
11. *Landa A., Soderlind P., Ruban A. et al.* // Ibid. – 2004. – **B70**, N 22. – art. 224210.
12. *Liu S.H.* // Physica. – 1997. – **B240**, N 1-2. – P. 49 – 60.
13. *Eriksson O., Soderlind P., Will J.M.* // Phys. Rev. – 1992. – **B45**, N 12. – P. 12588 – 12591.
14. *Soderlind P., Eriksson O., Johansson B., Wills J.M.* // Ibid. – 1995. – **B52**, N 18. – P. 13169 – 13176.
15. *Charpentier T., Zerah G., Vast N.* // Ibid. – 1996. – **B54**, N 3. – P. 1427 – 1430.
16. *Gasche T., Brooks M.S.S., Johansson B.* // Ibid. – N 4. – P. 2446 – 2452.
17. *Soderlind P.* // Adv. Phys. – 1998. – **47**, N 6. – P. 959 – 998.
18. *Jones M.D., Boettger J.C., Albers R.C.* // Phys. Rev. – 2000. – **B61**, N 4. – P. 4644 – 4650.
19. *Kunes J., Novak P., Schmid R., Blaha P., Schwarz K.* // Ibid. – 2001. – **B64**, N 15. – P. 153102 – 153103.
20. *Bouchet J., Jollet F., Zerah G.* // Ibid. – 2006. – **B74**, N 13. – P. 134304 – 134307.
21. *Feng J., Grochala W., Jaron T. et al.* // Phys. Rev. Lett. – 2006. – **96**, N 1. – art. 017006.
22. *Lipson A., Heuser B.J., Castano C. et al.* // Phys. Rev. – 2005. – **B72**, N 21. – art. 212507.
23. *Ashcroft N.W.* // Phys. Rev. Lett. – 2004. – **92**, N 18. – art. 187002.
24. *Poole C. Jr.* Handbook of Superconductivity. – San-Diego, San Francisco, N. Y., Boston, London, Tokio. – Academic Press, 2000.
25. *Satterthwaite C.B., Toepke I.L.* // Phys. Rev. Lett. – 1970. – **25**, N 4. – P. 741 – 745.
26. *Satterthwaite C.B., Peterson D.T.* // J. Less-Common Met. – 1972. – **26**, N 3. – P. 361 – 368.
27. *Dietrich M., Gey W., Rietsche H., Satterthwaite C.B.* // Solid State Comm. – 1974. – **15**, N 5. – P. 941 – 943.
28. *Weaver J.H., Knapp J.A., Eastman D.E. et al.* // Phys. Rev. Lett. – 1977. – **39**, N 10. – P. 639 – 642.
29. *Brooks M.S.S., Johansson B.* // Physica. – 1985. – **B130**. – P. 516 – 519.
30. *Shein I.R., Shein K.I., Medvedeva N.I., Ivanovskii A.L.* // Physica B. Cond. Matter. – 2007. – **389**, N 2. – P. 296 – 301.
31. *Miller J.F., Caton R.H., Satterthwaite C.B.* // Phys. Rev. – 1976. – **B14**, N 7. – P. 2795 – 2800.
32. *Walti Ch., Felder E., Degen C. et al.* // Ibid. – 2001. – **B64**, N 17. – art. 172515.
33. Кузьма Ю.Б. Кристаллохимия боридов. – Львов: Изд-во "Вища школа", 1983.
34. *Шеин И.Р., Шеин К.И., Швейкин Г.П., Ивановский А.Л.* // Докл. РАН, сер. физ. химия. – 2006. – **407**, № 6. – С. 789 – 792.
35. *Konrad Th., Jeitschko W., Danebrock M.E., Evers C.B.H.* // J. Alloys Compounds. – 1996. – **234**, N 1. – P. 56 – 61.
36. Ивановский А.Л., Швейкин Г.П. Квантовая химия в материаловедении. Бор, его сплавы и соединения. – Екатеринбург: УрО РАН, 1997.
37. *Das T., Deb S., Mookerjee A.* // Physica. – 2005. – **B367**, N 1. – P. 6 – 18.
38. *Shein I.R., Shein K.I., Ivanovskii A.L.* // J. Nuclear Mater. – 2006. – **353**, N 1. – P. 19 – 26.
39. *Nelhiebel M., Louf P.H., Schattschneider P. et al.* // Phys. Rev. – 1999. – **B59**, N 20. – P. 12807 – 12814.
40. *Shein I.R., Shein K.I., Medvedeva N.I., Ivanovskii A.L.* // Phys. Stat. Sol. (b). – 2007. – P. 1 – 8. / DOI 10.1002/pssb.200743125.
41. *Sedmidubsky D., Konings R., Novak P.* // J. Nucl. Mater. – 2005. – **344**, N 1. – P. 40 – 44.
42. *Gouder T., Havela L., Black L. et al.* // J. Alloys Comp. – 2002. – **336**, N 1. – P. 73 – 76.
43. *Adachi J., Kurosaki K., Uno M. et al.* // Ibid. – 2005. – **394**, N 3. – P. 312 – 316.
44. *Ayniyas M., Sanyal S.P., Jha P.K.* // Phys. Stat. Sol. (b). – 2002. – **229**, N 3. – P. 1459 – 1466.
45. *Ganguly C.* High Tech Ceramics (Ed. P. Vincenzini) – Amsterdam: Elsevier, 1987.
46. *Ackermann R.J., Rauh E.G.* // J. Inorg. Nucl. Chem. – 1973. – **35**, N 12. – P. 3787 – 3794.
47. *Benedict U.* // J. Less-Common Met. – 1987. – **128**, N 1. – P. 7 – 45.
48. Тетерин Ю.А., Тетерин А.Ю. // Успехи химии. – 2004. – **73**, № 6. – С. 588 – 631.
49. *Шеин И.Р., Шеин К.И., Ивановский А.Л.* // Письма в ЖТФ. – 2007. – **33**, № 3. – С. 72 – 79.
50. Лазарев В.Б., Соболев В.В., Шаплыгин И.С. Химические и физические свойства простых оксидов металлов. – М.: Наука. – 1983.
51. *Ellis W.P., Boring A.M., Allen J.W. et al.* // Solid State Commun. – 1989. – **72**, N 12. – P. 725 – 728.

52. Boettger J.C., Ray A.K. // Intern. J. Quantum Chem. – 2002. – **90**, N 4-5. – P. 1470 – 1477.
53. Terki R., Feraoun H., Bertrand G. et al. // Comput. Mater. Sci. – 2005. – **33**, N 1-3. – P. 44 – 52.
54. Kanchana V., Vaitheswaran G., Svane A. et al. // J. Phys.: Cond. Matter. – 2006. – **18**, N 42. – P. 9615 – 9624.
55. Maehira T., Hotta T. // J. Magn. Magn. Mater. – 2007. – **310**. – P. 754 – 756.
56. Shein I.R., Shein K.I., Ivanovskii A.L. // J. Nucl. Mater. – 2007. – **361**, N 1. – P. 69 – 77.
57. Teterin Yu.A., Terekhov V.A., Teterin A.Yu. et al. // J. Electron Spectr. Relat. Phenom. – 1998. – **96**, N 1-3. – P. 229 – 236.
58. Olsen J.S., Gerward L., Kanchana V. et al. // J. Alloys Comp. – 2004. – **381**, N 1. – P. 37 – 40.
59. Wang J., Yip S., Phillpot S.R. et al. // Phys. Rev. Lett. – 1993. – **71**, N 25. – P. 4182 – 4185.
60. Chen Q., Sundman B. // Acta Mater. – 2001. – **49**, N 6. – P. 947 – 961
61. Kral C., Lengauer W., Rafaja D., Ettmayer P. // J. Alloys Comp. – 1998. – **265**, N 1-2. – P. 215 – 233
62. Haines J., Leger J.M., Bocquillon G. // Ann. Rev. Mater. Res. – 2001. – **31**. – P. 1 – 23
63. Jhi S.-H., Ihm J., Louie S.G., Cohen M.L. // Nature. – 1999. – **399**, N 6732. – P. 132 – 134.
64. Гольдшмидт Дж. Фазы внедрения. Т.1 – М.: Мир, 1971.
65. Самсонов Г.В., Унадхая Г.Ш., Неинпор В.С. Физическое материаловедение карбидов. – М.: Металлургия, 1976.
66. Том Л. Карбиды и нитриды переходных металлов. – М.: Мир, 1974.
67. Свойства, получение и применение тугоплавких соединений. Справочник / Под ред. Т.Я. Косолаповой – Киев: Наукова Думка, 1986.
68. Gubanov V.A., Ivanovskii A.L., Zhukov V.P. Electronic Structure of Refractory Carbides and Nitrides. Cambridge: University Press, 1994.
69. Lengauer W. Transition metal carbides, nitrides and carbonitrides, in Handbook of Ceramic Hard Materials (Ed. R. Riedel), Vol. I, Wiley-VCH, Weinheim, 2000. – P. 202 – 252.
70. Kieffer R., Wruss W., Constant K. et al. // Monatsh. Chem. – 1975. – **106**, N 14. – S. 1349 – 1356.
71. Richter V., Beger A., Drobniowski J. et al. // Mater. Sci. Eng. – 1996. – **A209**, N 1-2. – P. 353 – 357.
72. Yang Q., Lengauer W., Koch T. et al. // J. Alloys Comp. – 2000. – **309**, N 1-2. – L5 – L9.
73. Jhi S.H., Ihm J. // Phys. Rev. – 1997. – **B56**, N 21. – P. 13826 – 13829.
74. Jhi S.H., Ihm J., Louie S.G. et al. // Nature. – 1999. – **399**, N 6732. – P. 132 – 134.
75. Klein B.M. // Ibid. – P. 108 – 109.
76. Zaoui A., Bouhafs B., Ruterana P. // Mater. Chem. Phys. – 2005. – **91**, N 1. – P. 108 – 115.
77. Kolb B., Hart G. // Phys. Rev. – 2005. – **B72**, N 22. – art. 224207.
78. Calmels L., Miggue C., Kihn Y. // Ibid. – 2006. – **B73**, N 2. – art. 024207.
79. Street R.S., Waters T.N. // J. Less Common Met. – 1963. – **5**, N 3. – P. 295 – 301.
80. Benz R., Balog G. // High. Temp. Sci. – 1971. – **3**, N 5. – P. 511 – 515.
81. Александров К.С., Безносиков Б.В. Перовскиты: настоящее и будущее. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004.
82. Purohit R.D., Tyagi A.K., Mathews M.D. et al. // J. Nucl. Mater. – 2000. – **280**, N 1. – P. 51 – 55.
83. Ali M., Mishra R., Bharadwaj S.R. et al. // Ibid. – 2001. – **299** N 2. – P. 165 – 170.
84. Dash S., Singh Z., Parida S.C. et al. // J. Alloys Comp. – 2005. – **398**, N 1-2. – P. 219 – 227.
85. Prasad R., Dash S., Parida S.C. et al. // J. Nucl. Mater. – 2003. – **312**, N 1. – P. 1 – 9.
86. Subasri R., Mallika C., Mathews T. // Ibid. – N 2-3. – P. 249 – 256.
87. Goodenough L.R., Lango J.M. Landolt-Börnstein Tables, Group III, vol. 4a. – Berlin: Springer, 1970.
88. Solovyev I., Hamada N., Terakura K. // Phys. Rev. – 1996. – **B53**, N 11. – P. 7158 – 7170.
89. Matar S.F. // Progr. Solid State Chem. – 2003. – **31**, N 3. – P. 239 – 299.
90. Kennedy B.J., Howard C.J., Chakoumakos B.C. // Phys. Rev. – 1999. – **B59**, N 6. – P. 4023 – 4027.
91. Smith A.J., Welch A.J.E. // Acta Crystallogr. – 1960. – **13**. – P. 653 – 559.
92. Terki R., Feraoun H., Bertrand G., Aourag H. // Phys. Stat. Sol. (b). – 2005. – **242**, N 5. – P. 1054 – 1062.
93. Terki R., Feraoun H., Bertrand G., Aourag H. // Comp. Mater. Sci. – 2005. – **33**, N 1-3. – P. 44 – 52.
94. Mete E., Shaltaf R., Ellialtioglu S. // Phys. Rev. – 2003. – **B68**, N 3. – art. 035119.
95. Yamanaka S., Kurosaki K., Maekawa T. et al. // J. Nucl. Mater. – 2005. – **344**, N 1-3. – P. 61 – 66.
96. Brese N.E., DiSalvo F.J. // J. Solid State Chem. – 1995. – **120**, N 2. – P. 378 – 380.
97. Niewa, R., DiSalvo F.J. // Chem. Mater. – 1998. – **10**, N 10. – P. 2733 – 2752.
98. Bannikov V.V., Shein I.R., Ivanovskii A.L. // Phys. Stat. Sol. – 2007. – (RRL) **1**, N 3. – P. 89 – 91.
99. Meldrum A., Boatner L.A., Ewing R.C. // Miner. Mag. – 2000. – **64**, N 2. – P. 185 – 194.
100. Mordberg L.E. // Ibid. – 2004. – **68**, N 3. – P. 489 – 497.
101. Mullica D.F., Grossie D.A., Boatner L.A. // J. Sol. State Chem. – 1985. – **58**, N 1. – P. 71 – 77.
102. Meldrum A., Zinkle S.J., Boatner L.A. et al. // Phys. Rev. – 1999. – **B59**, N 6. – P. 3981 – 3992.

103. Mazeina L., Ushakov S.V., Navrotsky A. et al. // *Geochim. Cosmochim. Acta*. – 2005. – **69**, N 19. – P. 4675 – 4683
104. Шеин К.И., Шеин И.Р., Медведева Н.И. и др. // *Докл. РАН, сер. физ. химия*. – 2006. – **409**, № 1. – С. 198 – 201.
105. Shein I.R., Shein K.I., Medvedeva N.I., Ivanovskii A.L. // *Phys. Stat. Sol.* – 2006. – **243** (b), N 6. – R44 – R46.
106. Shein I.R., Shein K.I., Ivanovskii A.L. // *Phys. Chem. Miner.* – 2006. – **33**, N 8-9. – P. 545 – 552.
107. Grover V., Tyagi A.K. // *J. Alloys Comp.* – 2005. – **390**, N 2. – P. 112 – 114.
108. Grover V., Chakraborty K.R., Tyagi A.K. // *Powder Diffraction*. – 2005. – **20**, N 3. – P. 215 – 217.
109. Johan Z., Johan V. // *Miner. Petrology*. – 2005. – **83**, N 1-2. – P. 113 – 150.
110. Parnell J., Eakin P. // *Miner. Mag.* – 1989. – **53**, N 1. – P. 11 – 16.
111. Robertson J., Xiong K., Clark S.J. // *Thin Solid Films*. – 2006. – **496**, N 1. – P. 1 – 7.
112. Wiech G., Kurmaev E.Z. // *J. Phys. C: Solid State Phys.* – 1985 – **18**, N 12. – P. 4393 – 4402.
113. Klein G., Chun H.U. // *Phys Stat. Sol. (b)*. – 1972. – **49**, N 2. – P. 167 – 174.